



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Centro Politécnico Superior



PROYECTO FIN DE CARRERA

Ingeniería de Telecomunicaciones

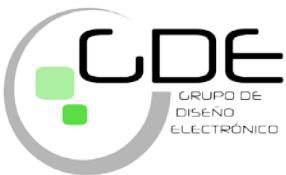
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE AMPLIFICADOR DE TRANSIMPEDANCIA Y ECUALIZADOR PARA COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA CON FIBRA ÓPTICA DE PLÁSTICO

(MEMORIA 1/2)

AUTOR: IGNACIO LOPE MORATILLA

DIRECTOR: JAVIER MATEO GASCÓN

Zaragoza Septiembre 2010



Grupo de Diseño
Electrónico



Departamento Ingeniería
Electrónica y de Comunicaciones

GTF
Photonic Technologies
Group

Grupo de Tecnologías
Fotónicas

Agradecimientos

En primer lugar, debo agradecer la oportunidad que me han dado tanto el director de este PFC, D. Javier Mateo Gascón, como D. Santiago Celma Pueyo de poder realizar este trabajo y formar parte de sus proyectos de investigación. Su apoyo y confianza en mi trabajo han sido fundamentales, no solamente en el desarrollo de este proyecto sino también en mi formación como investigador.

Imprescindible la aportación del Grupo de Diseño Electrónico (GDE) y del Grupo de Tecnologías Fotónicas (GTF) por el material y ayuda técnica proporcionada a lo largo de todo el proyecto. No menos transcendente ha sido el apoyo intelectual y técnico proporcionado por el Servicio de Instrumentación de la Universidad de Zaragoza. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos.

Destacar el apoyo recibido de D. Óscar Lasarte, por su disponibilidad y respaldo técnico a lo largo de mi estancia en el GDE. De D. Pedro Martínez, por su asesoramiento y colaboración, enriqueciendo en todo momento el trabajo realizado. De D. José Barquillas, por esos momentos en los que ha conseguido que mi estancia sea más agradable.

Mi reconocimiento al MEC y al I3A, instituciones que me han permitido la realización de una Beca de Colaboración y una Beca Multidisciplinar de Iniciación a la Investigación respectivamente. También agradecer la financiación y apoyo proporcionado por los diferentes proyectos de investigación en los que he colaborado: MICINN (TEC2008-05455/TEC, TEC2009-14718-C03-02) y DGA (PI127/08). Esto me ha permitido aprender la metodología y los pasos a seguir en un trabajo de investigación.

Gracias a la desinteresada colaboración de D. Julen Urdangarín y D. José María García del Pozo he disfrutado y aprendido de una de las cosas que más valoro después de este proyecto: trabajar en equipo. Y si esto significa, como es el caso, el surgimiento de una sólida amistad, pues mejor. Julen, muchas gracias por ayudarme a cumplir este objetivo como si fuera tuyo. Chema, agradecerte de la forma más sincera, tu esfuerzo, dedicación, orientación, paciencia, motivación, persistencia... Ha sido un privilegio contar con tus consejos y conocimientos.

Resumen

Diseño e implementación de amplificador de transimpedancia y ecualizador para comunicaciones de banda ancha con fibra óptica de plástico.

En este Proyecto Fin de Carrera (PFC), se ha realizado un sistema óptico para comunicaciones de banda ancha con fibra óptica de plástico (POF). Todo ello utilizando componentes comerciales. El objetivo final ha sido corregir las limitaciones frecuenciales de la POF mediante técnicas de ecualización analógica, consiguiendo aumentar el ancho de banda (BW) del sistema y, por lo tanto, disminuyendo la tasa de error (BER). Para ello se ha realizado el diseño y la implementación de un amplificador de transimpedancia (TIA) y de un ecualizador (EQ), siendo esto el núcleo central del PFC.

El TIA y el ecualizador se han diseñado buscando un compromiso entre ancho de banda, ganancia, ruido y consumo. Otra condición de diseño ha sido el bajo coste, que es intrínseco a los sistemas POF. En la etapa de diseño analítico, se realiza un estudio de las diferentes configuraciones y componentes, utilizando simulación SPICE para la optimización del diseño.

Una vez finalizado el proceso anterior, se procede al diseño e implementación de las diferentes Placas de Circuito Impreso (PCB), aplicando las reglas básicas de EMI/EMC para su correcto funcionamiento.

Finalmente, se ha utilizado la instrumentación específica para la caracterización experimental del sistema óptico, poniendo en relieve la mejora que proporciona el ecualizador.

- **Palabras Clave:** Ecualizador, Fibra Óptica de Plástico (POF), Amplificador de Transimpedancia (TIA), Comunicaciones Serie, Diseño PCBs.

Índice General

Índice de Figuras y Tablas	I
Símbolos	III
Acrónimos.....	V
<u>CAPÍTULO 1: Introducción</u>	7
1.1. Interés y Objetivos del Proyecto	8
1.2. Contexto	9
1.3. Descripción del Proyecto y Metodología	10
1.4. Fases y Programación del Trabajo.....	10
1.5. Herramientas Utilizadas	11
1.6. Contenidos de la Memoria	12
<u>CAPÍTULO 2: Sistema de comunicación para banda ancha POF</u>	13
2.1. Visión General.....	14
2.2. Transmisor	15
2.3. Fibra Óptica de Plástico (POF)	16
2.4. Fotodetector.....	19
2.5. Preamplificador	21
2.5.1. Análisis de etapas preamplificadoras.....	21
2.5.2. Diseño del amplificador de transimpedancia (TIA)	25
2.6. Ecualizador.....	28
2.6.1. Análisis de etapas ecualizadoras	28
2.6.2. Diseño del ecualizador (EQ).....	32
<u>CAPÍTULO 3: Caracterización experimental</u>	35
3.1. Láser.....	36
3.2. Sistema completo	38
3.3. Caracterización experimental del sistema completa	41
<u>CAPÍTULO 4: Conclusiones</u>	45
4.1. Conclusiones Generales.....	46
4.2. Líneas Futuras.....	47
4.3. Valoración Personal.....	48
Referencias	49

<u>ANEXO I: Técnicas de Ecualización Adaptativa</u>	53
I.1. Introducción	54
I.2. Clasificación	54
<u>ANEXO II: Descripción de la Instrumentación.....</u>	57
II.1. DCA 86100C, Agilent.....	58
II.2. BERT N4906A, Agilent.....	60
II.3. ZVL 9KHz/6GHz, R&S	60
II.4. Multimeter 3458A, Agilent.....	61
II.5. FM300, Fotec m.....	61
<u>ANEXO III: Hojas de Características</u>	63
III.1. Red laser diode. DL 3149-057, Sanyo	64
III.2. SI-POF. ESKA Premier GH 4002 2.2 mm, Mitsubishi.....	65
III.3. Fotodiodo. Si PIN S5972, Hamamatsu	66
III.4. Transistor. BFP640, Infineon	69
III.5. Array de Transistores. HFA3127, Intersil.....	73
III.6. Bias-T. ZFBT-4R2G+, Minicircuits.....	79
III.7. Balun. Model BIB-100G, Prodyn	81
<u>ANEXO IV: Publicaciones del Autor</u>	83
IV.1. Introducción	84
IV.2. “Low-Cost TIA and Equalizer For SI-POF”. 19th International Conference on Plastic Optical Fibers	
IV.3. “1.8V - 3GHz CMOS Limiting Amplifier with Feedforward Frequency Compensation”. Microelectronics Reliability	
IV.4. “A 0.18 μ m CMOS Integrated Transimpedance Amplifier- Equalizer for 2.5 Gb/s”. IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems	

Índice de Figuras y Tablas

- **Índice de Figuras**

1.1.	Instalación de POF junto al cableado eléctrico	8
1.2.	Espacio multidimensional en el diseño analógico [RAZ99]	9
2.1.	Esquemático de nuestro sistema óptico completo	14
2.2.	Diagramas de emisión de un (a) LD y (b) VCSEL [GIO03].....	15
2.3.	Núcleo, cubierta y revestimiento de una PMMA-POF [GAR08]	16
2.4.	Distribución de índices de refracción, pulso de entrada, diagrama de rayos en la POF y pulso de salida. SI-POF (superior) y GI-POF (inferior) [ARA10]	17
2.5.	Efecto de la dispersión y atenuación en una transmisión por fibra óptica [GAR08].....	17
2.6.	Respuesta frecuencial de la fibra para diferentes longitudes [MAT05].....	18
2.7.	Responsividad de: (a) S597X Series, Hamamatsu (Si PIN PD), [Anexo III] y (b) T1670P, Vishay (Si PIN PD), [VIS10].....	19
2.8.	Capacidad parasite de deplexión: (a) Serie S597X, Hamamatsu (Si PIN PD) [Anexo III] y (b) T1670P, Vishay (Si PIN PD) [VIS10]	20
2.9.	Fotodiodo: (a) Símbolo y (b) modelo de pequeña señal del PD.....	20
2.10.	Preamplificador de carga resistiva pasiva: (a) circuito y (b) modelo equivalente	21
2.11.	TIA: (a) circuito y (b) modelo equivalente de pequeña señal.....	22
2.12.	Diagrama de Bloques de preamplificadores de modo corriente combinados con: (a) Carga resistiva pasiva y (b) TIA.....	23
2.13.	Configuraciones monoetapa: (a) emisor-común y (b) cascodo	24
2.14.	(a) Valores característicos del transistor BFP640, V_{BE} (azul) y β (verde). (b) Valores de las resistencias del TIA: R_F (azul) y R_C (verde). Todo ello en función de I_C y con $V_C=1.7$	25
2.15.	Modelo equivalente para pequeña señal del TIA.....	26
2.16.	<i>Capability</i> normalizada del TIA en función de I_C	27
2.17.	Arquitectura del preamplificador propuesto	27
2.18.	Respuesta representativa del canal, ecualizador y respuesta global para el caso ideal y real	29
2.19.	Diagrama de bloques de un EQ-CT. La respuesta obtenida es un filtro paso-alta de ganancia variable	30
2.20.	Arquitectura del EQ propuesto: par diferencial con degeneración de fuente....	31
2.21.	Esquema del espejo de corriente implementado	32
2.22.	<i>Capability</i> normalizada del EQ en función de I_C	33
2.23.	Modelo equivalente de pequeña señal del EQ.....	34

2.24.	Esquemático del EQ propuesto	34
3.1.	LD: (a) Esquemático de la PCB y (b) implementación.....	36
3.2.	Setup para la caracterización del láser	37
3.3.	Recta de carga experimental del <i>red laser diode</i> DL 3149-057	37
3.4.	Arquitectura del <i>front-end</i> complete	38
3.5.	Esquemático de la PCB del <i>front-end</i>	40
3.6.	Trazado pistas cara <i>top</i> del <i>front-end</i>	40
3.7.	PCB <i>front-end</i> implementada: (a) <i>top</i> y (b) <i>bottom</i>	40
3.8.	Setup de medida del circuito bajo test (DUT).....	41
3.9.	Configuraciones caracterización del sistema completo: (a) Respuesta frecuencial y (b) Transmisión de datos.....	41
3.10.	Respuesta frecuencial del sistema POF	43
3.11.	Diagrama de ojo para $2^{31}-1$ NRZ PRBS. $R_1=220\ \Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $C_2 = 10\ \text{pF}$. Longitud de fibra 30 m y tasa 800 Mb/s.....	43
3.12.	Diagrama de ojo para $2^{31}-1$ NRZ PRBS. $R_1=220\ \Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $C_2 = 8.2\ \text{pF}$. Longitud de fibra 20 m y tasa 800 Mb/s.....	43
3.13.	Diagrama de ojo para $2^{31}-1$ NRZ PRBS. $R_1=220\ \Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $C_2 = 5\ \text{pF}$. Longitud de fibra 10 m y tasa 800 Mb/s.....	43
3.14.	Distribución del ruido en función del estado lógico “1/0”	43
I.1.	Diagrama de bloques de un ecualizador adaptativo	54
I.2.	Diagrama de bloques de ecualizadores analógicos adaptativos de alta velocidad: (a) Obtiene la diferencia de la componente en DC antes y después de un <i>slicer</i> [BAB98](b) compara la componente en DC con la potencia total recibida [SUN05] y (c) analiza la señal a 200 MHz y a 600 MHz para una aplicación de transmisión por cable coaxial a 3.2 Gbps [MAX01]	55
II.1.	Analizador de redes. DCA 86100 C, Agilent [AGI05].....	58
II.2.	Método de muestreo y reconstrucción en un osciloscopio de tiempo equivalente: (a) Diagrama de ojo y (b) Modo osciloscopio normal [AGI05]	59
II.3.	Medidor Tasa de Error. BERT N4906A, Agilent [AGI08]	60
II.4.	Analizador de Redes Vectorial. ZVL 9KHz/6GHz, R&S [R&S09]	60
II.5.	Multímetro de Precisión. <i>Multimeter</i> 3458A, Agilent [AGI01].....	61
II.6.	Medidor de Potencia Óptica para Fibra. FM300, Fotec m [FOT00]	61

• **Índice de Tablas**

1.1.	Diagrama de Gantt que detalla el plan de trabajo	10
2.1.	Análisis de las Técnicas de Ecualización	30
4.1.	Comparativa con otros autores	46

Símbolos

β	Ganancia en Corriente
ϕ	Diámetro
λ	Longitud de Onda
BW	Ancho de Banda
BW_n	Ancho de Banda del ruido blanco referido a la entrada
C_{bc}	Capacidad Base-Colector
C_{be}	Capacidad Base-Emisor
C_d	Capacidad de Unión
C_{DEC}	Condensador de Desacoplo
C_N	<i>capability</i> normalizada
G	Ganancia
H_x	Función de Transferencia
I_c	Corriente del Colector
$i_{n,TIA}^2$	Ruido Referido a la Entrada del TIA
k	Constante de Boltzman
n_{cla}	Índice de Refracción de la cubierta
n_{co}	Índice de Refracción del núcleo
P_{opt}	Potencia Óptica
q	Carga Eléctrica del Electrón
Q_i	Transistor
r_{be}	Resistencia Base-Emisor
r_o	Resistencia de Colector-Emisor
s	Frecuencia Compleja
Si	Silicio
S_{intr}	Polo Intrínseco
S_p	Polo Complejo
S_z	Cero Complejo
T	Temperatura
T_R	TransResistencia
V_{BE}	Voltaje en Continua de Base-Emisor
V_{BF}	Voltaje Polarización en Inversa
V_C	Voltaje en Continua de Colector
V_{CE}	Voltaje en Continua de Colector-Emisor
V_{DD}	Tensión de Alimentación
V_R	Voltaje en Inversa
Z_{in}	Impedancia de Entrada

Acrónimos

3DTV	<i>Three-Dimensional Television</i>
AC	<i>Alternating Current</i>
ADC	<i>Analog to Digital Converter</i>
BER	<i>Bit Error Rate</i>
BERT	<i>Bit Error Rate Test</i>
BW	<i>BandWidth</i>
CAD	<i>Computer Aided Design</i>
CAM	<i>Computer Aided Manufacturing</i>
CMOS	<i>Complementary Metal-Oxide-Semiconductor</i>
DC	<i>Direct Current</i>
DCA	<i>Digital Communications Analyzer</i>
DUT	<i>Device Under Test</i>
DVD	<i>Digital Versatile Disc</i>
EMC	<i>ElectroMagnetic Compatibility</i>
EMI	<i>ElectroMagnetic Interference</i>
EQ	<i>EQualizer</i>
EQ-CT	<i>EQualizer Continuous Time</i>
EQ-P	<i>EQualizer Passive</i>
FIR	<i>Finite Impulse Response</i>
FOM	<i>Figure Of Merit</i>
FTTH	<i>Fiber To The Home</i>
GDE	Grupo de Diseño Electrónico
GI-POF	<i>Graded-Index Plastic Optic Fiber</i>
GOF	<i>Glass Optic Fiber</i>
GTF	Grupo de Tecnologías Fotónicas
HDTV	<i>High Definition TeleVision</i>
I3A	Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
IPTV	<i>Internet Protocol Television</i>
ISI	<i>Interference Inter-Symbol</i>
LA	<i>Limiter Amplifier</i>
LAN	<i>Local Area Network</i>
LD	<i>Laser Diode</i>
LMS	<i>Least Mean Square Error</i>
MEC	Ministerio de Educación y Ciencia
MICINN	Ministerio de Ciencia e Innovación
MSE	<i>Mean Squared Error</i>

NRZ	<i>Non Return to Zero</i>
PCB	<i>Printed Circuit Board</i>
PD	<i>PhotoDiode</i>
PFC	Proyecto Fin de Carrera
PIN	<i>PN junction with Isolated region</i>
PMMA	Polimetacrilato
POF	<i>Polymer Optic Fiber</i>
PRBS	<i>PseudoRandom Binary Sequence</i>
RX	Receiver
S&H	<i>Sample and Hold</i>
SI-POF	<i>Step-Index Plastic Optic Fiber</i>
SMA	<i>SubMiniature - Version A</i>
SMD	<i>Surface Mounted Device</i>
SNR	<i>Signal to Noise Ratio</i>
SOIC	<i>Small-Outline Integrated Circuit</i>
SOT	<i>Small Outline Transistor</i>
SPICE	<i>Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis</i>
TIA	<i>TransImpedance Amplifier</i>
TX	<i>Transmitter</i>
VCSEL	<i>Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser</i>

1

Introducción

- 1.1. Interés y Objetivos del Proyecto
- 1.2. Contexto
- 1.3. Descripción del Proyecto y Metodología
- 1.4. Fases y Programación del Trabajo
- 1.5. Herramientas Utilizadas
- 1.6. Contenidos de la Memoria

En este capítulo se describe el objetivo y alcance del proyecto, el contexto en que se realiza, la forma en que se aborda el problema –metodología, programación del trabajo y herramientas utilizadas- y, finalmente, se detallan los contenidos de la memoria.

Es sabido que en los sistemas de comunicación los niveles de interferencia inter-símbolo (ISI) aumentan considerablemente conforme la velocidad de transmisión o *bitrate* supera el ancho de banda (BW) del canal de transmisión. En consecuencia, la tasa de error de transmisión (BER) puede ser inaceptable para un determinado estándar de comunicación.

La solución más común para reducir el ISI es recurrir a la técnica de ecualización. Será ésta la técnica empleada en este Proyecto Fin de Carrera (PFC) para corregir la limitación frecuencial producida por la dispersión de la luz en las comunicaciones de fibra óptica de plástico (POF).

1.1. Interés y Objetivos del Proyecto

La POF representa una tecnología ya asentada en las comunicaciones serie de banda ancha, asegurando una buena calidad de servicio para aplicaciones emergentes como los servicios *triple-play*, IPTV y HDTV, e incluso para las necesidades futuras de 3DTV, cumpliendo estándares como Fast Ethernet o el IEEE 1394.

La aplicación de la fibra óptica de plástico en redes de comunicaciones de corta distancia (redes LAN) tiene un gran interés por diversos motivos que hacen que sea una alternativa tanto a la transmisión por hilo de cobre, por su mayor BW, como a la fibra óptica de vidrio (GOF), en el último tramo de redes Fiber to the Home (FTTH), debido principalmente a su mayor robustez y menor coste.

Entre las ventajas que ofrece la POF podemos citar: flexibilidad, ligereza, robustez, inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, que no produzca ni sufra interferencias por otras redes o sistemas inalámbricos y una fácil conectividad, como la tipo *garden hose*, Fig. 1.1, que permite una instalación rápida, sencilla -incluso junto al cableado eléctrico- y barata, pues no necesita personal especializado para su instalación y mantenimiento.

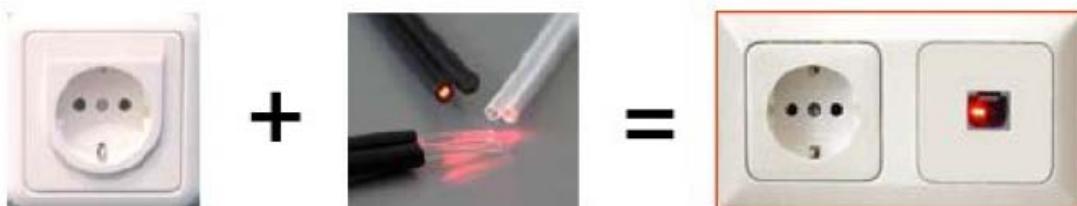


Fig. 1.1 Instalación de POF junto al cableado eléctrico.

Al utilizar la POF una luz dentro del espectro visible, es la única tecnología interconectada donde puede verse la señal en ambos extremos, lo que permite localizar los cortes y averías, a la vez que supone un aumento de la seguridad al no haber peligro de dañar a la retina como ocurre con la GOF.

El bajo coste y la mayor robustez de la POF conlleva unas limitaciones importantes, como su alta atenuación y su bajo ancho de banda. Siendo el objetivo de este PFC corregir la limitación frecuencial de la POF, se han implementado un preamplificador y un ecualizador analógico, ambos realizados con componentes pasivos y activos comerciales. Los objetivos de diseño, Fig. 1.2, han sido el bajo coste, inherente a los sistemas de comunicaciones POF, el bajo consumo y un compromiso entre ganancia, BW y ruido que nos proporcione una optimización del diseño.

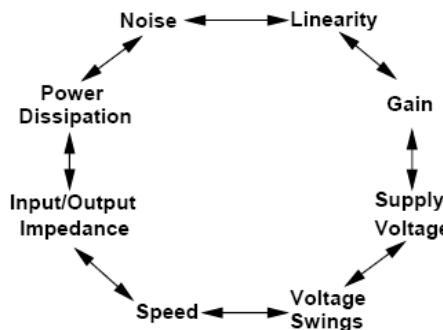


Fig. 1.2 Espacio multidimensional en el diseño analógico [RAZ99].

1.2. Contexto

Este PFC se encuadra en el ámbito de dos proyectos de investigación desarrollados en la Universidad de Zaragoza:

- *Estrategias de diseño de front-ends para comunicaciones ópticas* (TEC2008-05455/TEC) del Grupo de Diseño Electrónico (GDE).
- *Convergencia digital en el hogar mediante fibra óptica de plástico* (TEC2009-14718-C03-02) del Grupo de Tecnologías Fotónicas (GTF).

Durante la realización de este PFC el autor ha disfrutado de las siguientes becas:

- Beca de Colaboración, Sept. 2009/ Jun. 2010.
- Beca Multidisciplinar de Iniciación a la Investigación del I3A, Jul 2010 - Actualidad.

1.3. Descripción del Proyecto y Metodología

En este PFC se implementa un sistema óptico completo. El objetivo es compensar las limitaciones frecuenciales para diferentes longitudes de fibra, por lo que el trabajo desarrollado se centra en el diseño de un preamplificador y un ecualizador. De esta forma, se consigue un sistema que realiza una transmisión compatible con estándares de alta velocidad -como el IEEE 1394- para diferentes longitudes de fibra.

Para la realización del PFC, en primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica y un estudio de mercado de todas las partes del sistema. Simultáneamente, se ha procedido a un estudio en profundidad de las etapas preamplificadoras y de las técnicas de ecualización analógicas.

Vistas las opciones que da el mercado y las diferentes técnicas existentes, se aplican métodos de diseño electrónico para optimizar de manera interdependiente el preamplificador y el ecualizador. Todo ello basado en un análisis sistemático mediante simulación eléctrica.

Una vez elegidos los componentes y las estructuras definitivas, se da paso al diseño e implementación de las placas de circuito impreso (PCBs) correspondientes. A continuación, se procede a la caracterización experimental de los circuitos utilizando la instrumentación específica.

Finalmente, se efectúa una optimización, reevaluando todo lo ejecutado en cada una de las etapas del proceso de diseño, se extraen las principales conclusiones y se proponen líneas futuras de actuación.

1.4. Fases y programación del trabajo.

Una vez descrito el proyecto y su metodología, en el diagrama de Gantt siguiente, Tabla 1.1, se detalla el plan de trabajo de este PFC.

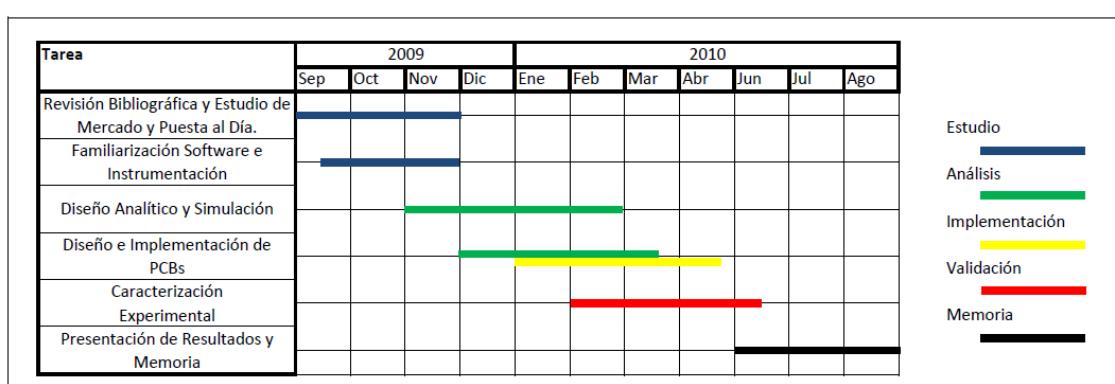


Tabla 1.1 Diagrama de Gantt que detalla el plan de trabajo.

1.5. Herramientas Utilizadas

Herramientas Informáticas:

- Micro-Cap: Este programa se ha utilizado para realizar la simulación eléctrica de los circuitos. Se trabaja con programación SPICE y se emplean para ello los modelos SPICE que modelan el comportamiento de cada componente. Destacar que es un programa que tiene una versión gratuita que permite implementar los diferentes circuitos de manera intuitiva [MIC08].
- Altium Designer: Es un programa de diseño de placas de circuito impreso. Este software de ingeniería concurrente permite integrar el diseño de los circuitos esquemáticos y sus correspondientes placas de circuito impreso. También permite generar los archivos estándar para la fabricación de PCBs, convirtiéndose entonces en una herramienta de CAD/CAM [ALT09].
- Matlab: Gracias a sus potentes herramientas computacionales y visuales, ha servido tanto de herramienta matemática como gráfica [MAT08].

Instrumentación:

- Analizador de Comunicaciones Digitales (DCA 86100C, Agilent): Osciloscopio de tiempo equivalente que permite analizar y visualizar señales periódicas, como pueden ser las señales PRBS (Secuencias de Bits Pseudoaleatorias) [AGI08].
- Medidor de Tasa de Error (BERT N4096A, Agilent): Genera señales PRBS que permiten, con su interacción con el DCA, obtener información sobre un sistema de transmisión. También permite medir el BER de un sistema [AGI05].
- Analizador de Redes Vectorial (ZVL 9KHz-6GHz, Rhode&Schwarz): Instrumento utilizado para obtener la respuesta frecuencial de los diferentes circuitos [R&S09].

En el anexo II se presentan de una manera más detallada tanto estos instrumentos como otros que se han empleado en la realización de este PFC.

1.6. Contenidos de la Memoria

- **Capítulo 1: Introducción**

Se explica el interés del proyecto y se definen los objetivos que se quieren alcanzar y su metodología. Además, se comentan los recursos utilizados a lo largo del PFC y se describe la estructura de la memoria.

- **Capítulo 2: Sistema de comunicación para banda ancha de POF**

Se realiza un repaso de los fundamentos teóricos de los diferentes componentes de un sistema de transmisión POF. Se procede, asimismo, a un estudio sobre el estado del arte de las diferentes configuraciones propuestas. Y se presenta el método de diseño electrónico, realizado mediante análisis teórico y simulación del TIA y del ecualizador.

- **Capítulo 3: Caracterización experimental**

Desarrolla la implementación y optimización de las diferentes PCBs. Detalla los *setup* necesarios para caracterizar el láser y el sistema completo. Por último, se analizan y exponen los resultados experimentales.

- **Capítulo 4: Conclusiones finales**

Tras una recapitulación del trabajo realizado, se extraen las conclusiones finales, se plantean posibles líneas futuras y se realiza una valoración personal.

2

Sistemas POF

- 2.1. Visión General
- 2.2. Transmisor
- 2.3. Fibra Óptica de Plástico (POF)
- 2.4. Fotodetector
- 2.5. Preamplificador
 - 1.5.1. Estudio de etapas preamplificadoras
 - 1.5.2. Diseño del Amplificador de Transimpedancia (TIA)
- 2.6. Ecualizador
 - 1.6.1. Estudio de Técnicas Ecualizadoras
 - 1.6.2. Diseño del ecualizador (EQ)

En este capítulo se muestra primero el esquema de un sistema de transmisión de datos óptico para, a continuación, explicar los componentes que conforman el sistema completo. En los apartados correspondientes al preamplificador y el ecualizador, se detalla el diseño analítico y por simulación realizado.

2.1. Visión General

Un sistema de transmisión óptico está formado por tres componentes básicos: el transmisor (TX), el canal de transmisión y, por último, el bloque que se encarga de la recepción de la señal óptica, el *front-end*. El esquema general del sistema óptico desarrollado se representa en la Fig. 2.1.

En el sistema propuesto, el bloque de transmisión óptico lo constituye el láser (LD), que es el que transforma las señales eléctricas en luminosas. El canal empleado es la POF, por donde se transmite la luz. El *front-end* del receptor, cuya implementación es la parte central de este PFC, completa el sistema.

En el *front-end*, se encuentra en primer lugar el fotodetector o fotodiodo (PD), que es el que transforma la señal luminosa en corriente eléctrica. La etapa que viene a continuación es la preamplificador (Pre), que es la encargada de convertir la corriente generada en voltaje. Sigue la etapa ecualizadora, cuyo objetivo es corregir las limitaciones frecuenciales del sistema y, así, mejorar la señal recibida. El último bloque es la etapa postamplificadora (Pos), la encargada de proporcionar valores digitales compatibles con la circuitería digital posterior.

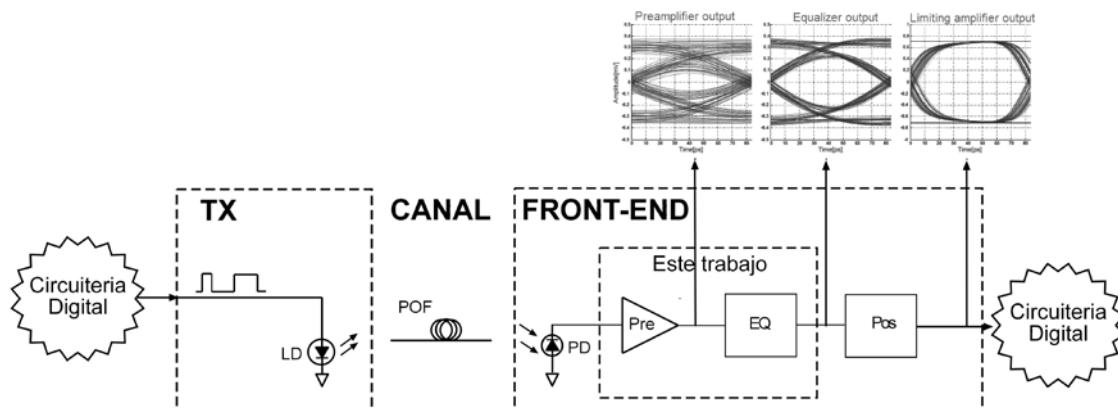


Fig. 2.1 Esquemático del sistema óptico completo.

2.2. Transmisor

En este sistema, como ya se ha dicho en el apartado anterior, la función de transmisor la realiza el láser, que es el que convierte la señal eléctrica a transmitir en luz. En las transmisiones POF para comunicaciones de banda ancha, la emisión se realiza con láseres semiconductores (LD) basados en emisión estimulada. Esta emisión se realiza en la parte roja del espectro visible, en torno a 660-670 nm de longitud onda (λ).

En la realización del PFC se ha utilizado un láser de bajo coste, el *red laser diode DL-3149-057*, Sanyo [Anexo III]. La principal aplicación de este láser es la de puntero láser, por lo que ha sido necesaria la implementación de una PCB específica para su uso como TX en comunicaciones de banda ancha. Hay que destacar que el uso de este tipo de láseres en comunicaciones POF fue bastante habitual hasta que se desarrollaron láseres específicos en el espectro visible para POF [ZIE08].

El desarrollo de láseres específicos de altas prestaciones para POF es uno de los ámbitos con mayor trabajo de investigación. Como demuestran las publicaciones internacionales, donde se están desarrollando los láseres VCSEL (emisión sobre superficie de cavidad vertical) en el rango de 660-680 nm [FIR06, ZIE08]. No obstante, hay que destacar el mayor inconveniente que presentan los VCSEL que se encuentran en el mercado: su alto precio.

Los criterios para elegir el LD especificado han sido: 1) el coste y 2) un comportamiento adecuado en el rango frecuencial de operación deseado. En la Fig. 2.2 se muestra de manera esquemática el diagrama de radiación de un LD y un VCSEL.

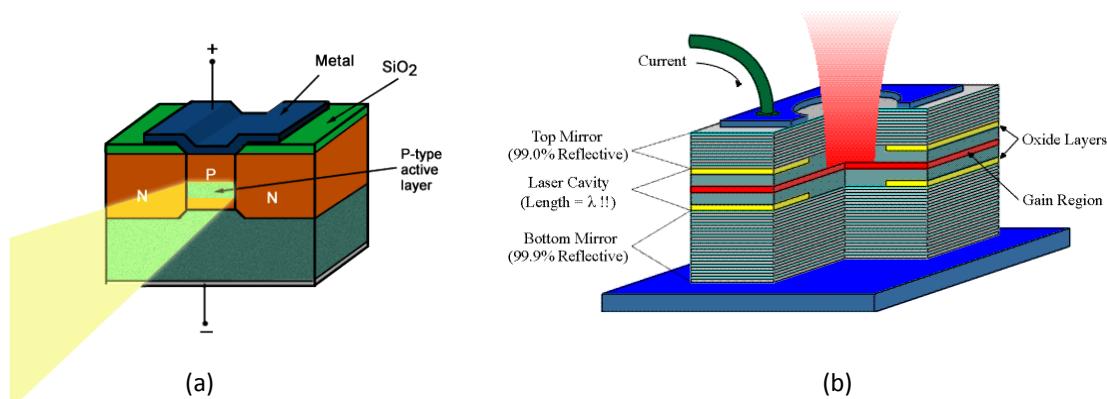


Fig. 2.2 Diagramas de emisión de un (a) LD y (b) VCSEL [GIO03]

2.3. Fibra Óptica de Plástico (POF)

La fibra óptica de plástico POF es el medio de transmisión en el sistema de comunicación óptico.

La POF es una guía de ondas cilíndrica formada por un polímero altamente transparente. El material más comúnmente utilizado es el polimetilmetacrilato (PMMA). La estructura física de la POF es la misma que la de las GOF y consta de tres partes, como se muestra en la Fig. 2.3.

El núcleo (*core*), en la POF, tiene una diámetro de hasta 1 mm, frente a 10 μm que puede tener el núcleo de la GOF; es la parte central de la fibra y por donde viaja la señal luminosa, por lo que su índice de refracción (n_{co}) ha de ser mayor que el de la cubierta (n_{cla}). La cubierta (*cladding*) envuelve el núcleo con un material similar al de éste, pero con un índice de refracción menor para que se produzca el fenómeno de la reflexión total interna y, así, los rayos de luz sean guiados hasta el otro extremo. La capa de revestimiento (*jacket*), normalmente un polímero fluorado, no tiene incidencia en el guiado de la luz y su función es proteger el núcleo y la cubierta.

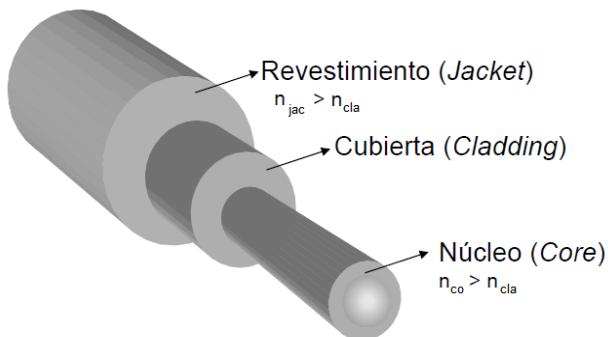


Fig. 2.3 Núcleo, cubierta y revestimiento de una PMMA-POF [GAR08].

La POF es una fibra multimodo que según el perfil de su índice de refracción puede ser de dos tipos, aquellos con una estructura de salto de índice (SI-POF) y los de índice gradual (GI-POF).

En las SI-POF, el índice de refracción del núcleo y de la cubierta son uniformes, siendo el del núcleo sensiblemente mayor, por lo que el cambio de índice de refracción al pasar de una zona a otra se produce bruscamente. En las GI-POF, el índice del núcleo varía gradualmente desde el centro del mismo hasta el revestimiento, por lo que se reduce la dispersión modal. En la Fig. 2.4, se muestra un esquemático del diagrama de rayos en ambos tipos de fibra.

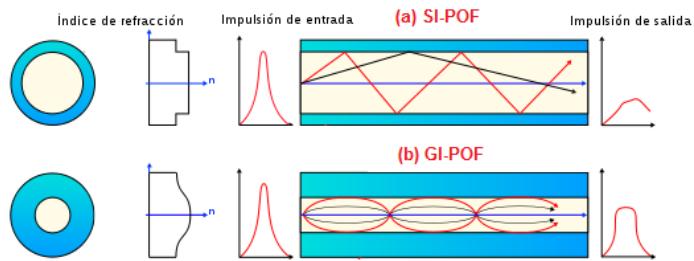


Fig. 2.4 Distribución de índices de refracción, pulso de entrada, diagrama de rayos en la POF y pulso de salida. SI-POF (superior) y GI-POF (inferior) [ARA10].

Los principales parámetros que limitan el BW y la velocidad de transmisión de la POF son la atenuación y la dispersión. Los efectos de estos dos parámetros en la transmisión se aprecian en la Fig. 2.5.

Las pérdidas en las fibras se pueden clasificar en intrínsecas, las que dependen del material, y extrínsecas, las que se deben a malas conexiones o curvaturas de la fibra. La atenuación intrínseca en la POF (≈ 200 dB/Km) es mucho mayor que la que se produce en la GOF (3 dB/Km), lo que limita la POF a aplicaciones de corta distancia.

Junto a la atenuación, el otro parámetro que limita el BW y la velocidad de transmisión es la dispersión. Entendiendo por dispersión el fenómeno por el cual un pulso se ensancha a medida que se propaga a través de la fibra. Esto se debe a que los distintos modos de la luz viajan a distintas velocidades y llegan al receptor en diferentes instantes de tiempo. Los principales tipos de dispersión son: modal, cromática y de polarización [ZIE08].



Fig. 2.5 Efecto de la dispersión y atenuación en una transmisión por fibra óptica [GAR08].

Si se analiza el efecto de la dispersión en el dominio de la frecuencia, se observa que las diferentes componentes frecuenciales sufren distintos retardos y atenuaciones. Las altas frecuencias son más fuertemente atenuadas. De esta forma, se puede afirmar que la POF tiene un marcado carácter de filtro paso-bajo, por lo que una ecualización que elimine esta limitación frecuencial es necesaria para comunicaciones con velocidades elevadas. Hay que destacar que tanto la atenuación como el BW de la POF varían en función de la longitud de la fibra, lo que impone la necesidad de una ecualización adaptativa.

La fibra que se va a utilizar es SI-POF, en concreto la ESKA Premier GH 4002 2.2 mm, Mitsubishi [Anexo III]. Este tipo de fibras suponen una limitación frecuencial mucho mayor que las GI-POF, sin embargo, la ventaja que tienen es su bajo coste. En la Fig. 2.6, se representa la respuesta frecuencial de esta fibra para diferentes longitudes.

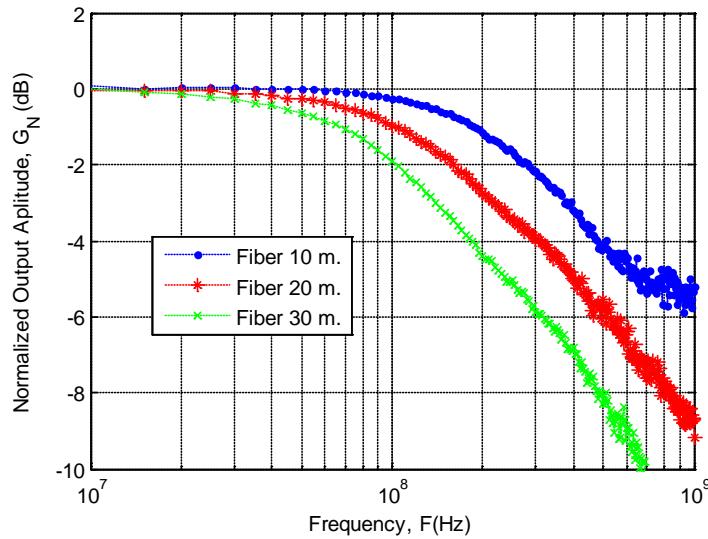


Fig. 2.6. Respuesta frecuencial de la fibra para diferentes longitudes [MAT05].

2.4. Fotodetector

El fotodetector es el primer dispositivo de los que conforman el *front-end*, y el encargado de convertir la luz que atraviesa la fibra en corriente eléctrica.

En las aplicaciones para comunicaciones de banda ancha POF, los fotodetectores más utilizados son los fotodiodos PIN (PD). Están fabricados con semiconductores de estado sólido, siendo el material más usado el Silicio (Si), por su reducido coste de fabricación y por presentar buena eficiencia en la longitud de onda de trabajo de la POF ($\lambda \approx 660$ nm), Fig. 2.7. Dicha eficiencia viene determinada por la responsividad del fotodiodo. Esta magnitud viene definida como la constante de proporcionalidad entre la corriente eléctrica generada por el fotodiodo y la potencia óptica incidente en el mismo.

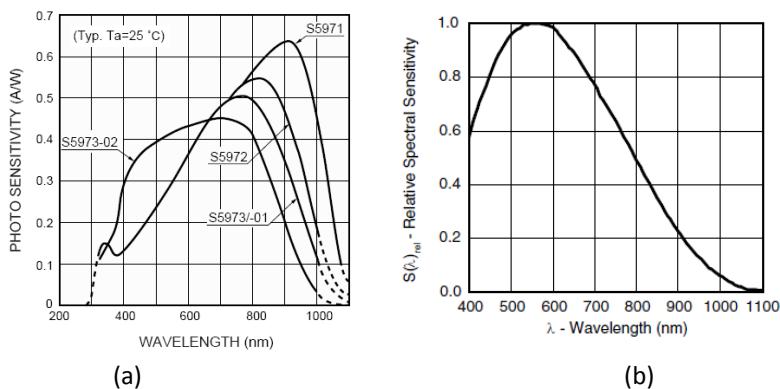


Fig. 2.7 Responsividad de: (a) S597X Series, Hamamatsu (Si PIN PD), [Anexo III] y (b) T1670P, Vishay (Si PIN PD), [VIS10].

Desde un punto de vista eléctrico, los dos parámetros que más determinan las prestaciones de un PD son: ruido y ancho de banda. El primero está relacionado con la densidad de ruido ($I_{N,PD}^2$). El segundo, con la capacidad de unión (C_d).

En todo sistema óptico es necesario que el ruido introducido por el PD sea reducido. Principalmente el PD genera ruido térmico y *shot*, siendo normalmente el segundo el término dominante. La densidad de ruido puede expresarse de manera aproximada por la ecuación 2.1. En esta expresión, I_{OFFSET} representa la componente en DC de la señal de entrada más la corriente de oscuridad del PD y q , la carga eléctrica del electrón [SÄC05]:

$$I_{N,PD}^2 \approx 2qI_{OFFSET} \quad (2.1)$$

Por otro lado, en un PD, la C_d es quien condiciona la respuesta en frecuencia. Esta magnitud depende del voltaje en inversa que se aplique al PD (V_R). Si se ponen valores altos de voltaje inverso, esta capacidad se ve reducida considerablemente. Esto puede ser visto en las siguientes gráficas proporcionadas por varios fabricantes, Fig. 2.8.

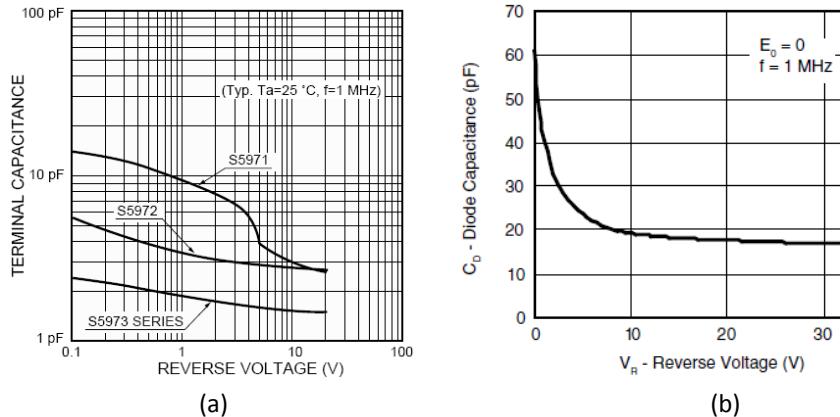


Fig. 2.8 Capacidad de unión: (a) Serie S597X, Hamamatsu (Si PIN PD) [Anexo III] y (b) T1670P, Vishay (Si PIN PD) [VIS10].

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el modelo para pequeña señal de un PD será el mostrado en la Fig. 2.9:

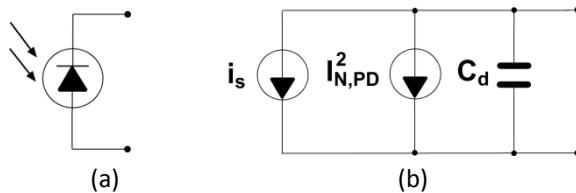


Fig. 2.9 Fotodiodo: (a) Símbolo y (b) modelo de pequeña señal del PD.

El fotodetector que se ha elegido es el S5972 Si-PIN PD, Hamamatsu, con distribución de pines T0-18 [Anexo III]. Un aspecto determinante, y que ha condicionado la elección de nuestro PD, ha sido su área de detección. Ésta viene condicionada por el diámetro de la POF ($\phi \approx 1 \text{ mm}$), puesto que ambos deben ser similares. Esta característica impone un rango de valores relativamente elevado para C_d : de 3 a 5 pF.

Las severas limitaciones frecuenciales impuestas por la POF y el fotodetector hacen imprescindible que deban aplicarse ciertas técnicas de ecualización que permitan compensar estas limitaciones y alcanzar las velocidades de transmisión adecuadas.

2.5. Preamplificador

En primer lugar, se realiza un estudio del estado del arte sobre las diferentes etapas preamplificadoras, eligiendo aquella etapa y componentes que después de un riguroso análisis teórico más convenga a esta aplicación. En el siguiente punto, se realiza un diseño analítico y por simulación con el fin de optimizar la etapa elegida.

2.5.1. Análisis de Etapas Preamplificadoras

El preamplificador se encarga de transformar la corriente generada por el fotodiodo en un voltaje de salida. Las condiciones ideales de un buen preamplificador son: alta transresistencia (T_R), elevado ancho de banda, bajo ruido referido a la entrada ($I_{N,IN}^2$) y bajo consumo en potencia.

En líneas generales, las tres implementaciones más comunes son: carga resistiva pasiva, amplificador de transimpedancia tipo *shunt-feedback* (TIA), y modo corriente [ING04]. A continuación se examinan las características de cada implementación.

Los preamplificadores basados en carga pasiva convierten la corriente fotogenerada en voltaje a través de una resistencia, R_F . Considerando el modelo de pequeña señal, Fig. 2.10, e incluyendo el ruido térmico generado por la resistencia R_F ($I_{N,RF}^2$), se obtienen los diferentes parámetros críticos de este tipo de preamplificador:

$$T_R = R_F \quad (2.2)$$

$$BW = \frac{1}{C_d R_F} \quad (2.3)$$

$$I_{N,IN}^2 = I_{N,PD}^2 + I_{N,RF}^2 = 2qI_{OFFSET} + \frac{4kT}{R_F} \quad (2.4)$$

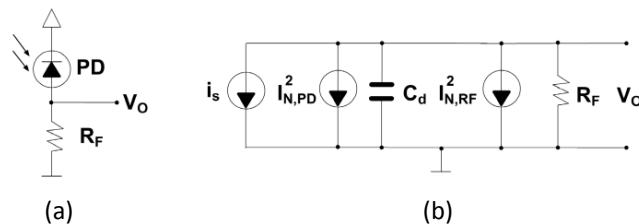


Fig. 2.10 Preamplificador de carga resistiva pasiva: (a) circuito y (b) modelo equivalente.

donde las magnitudes fundamentales que aparecen son: k , la constante de Boltzman; q , la carga eléctrica del electrón; y T , la temperatura ambiente ($T=300K$).

Si el valor de la resistencia es bajo, el BW será elevado, pero la sensibilidad del sistema se reduce notablemente. Esto último se debe a que la T_R se ve reducida y la contribución de ruido del sistema se ve incrementada. Sin embargo, si se elige una resistencia elevada, la situación sería la opuesta. La aplicación de esta etapa preamplificadora requiere el uso de postamplificadores de altas prestaciones, haciendo el diseño altamente complejo.

Situaciones intermedias a las expuestas con anterioridad se encuentran con el uso de preamplificadores TIA y los de modo-corriente. En la Fig. 2.11, se muestra la configuración básica del TIA y su modelo para pequeña señal. En esta configuración, la resistencia es conectada en un bucle de realimentación negativa a través de un amplificador de voltaje. Considerando este amplificador ideal con ganancia A_o y aplicando una aproximación de primer orden, se obtienen las magnitudes más importantes de este tipo de preamplificadores, mostradas en las siguientes ecuaciones [RAZ03]:

$$T_R(s \rightarrow 0) = \frac{-A_o}{1 + A_o} \cdot R_F \approx -R_F \quad \text{si } A_o \gg 1 \quad (2.5)$$

$$BW = \frac{1 + A_o}{C_d R_F} \approx \frac{A_o}{C_d R_F} \quad \text{si } A_o \gg 1 \quad (2.6)$$

$$I_{N,IN}^2 \approx I_{N,PD}^2 + I_{N,RF}^2 + I_{N,Amp}^2 \approx 2qI_{OFFSET} + \frac{4kT}{R_F} + I_{N,Amp}^2 \quad (2.7)$$

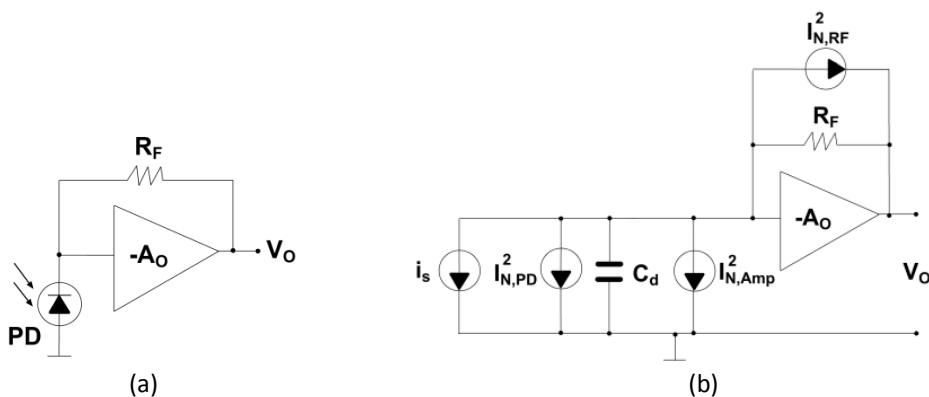


Fig. 2.11 TIA: (a) circuito y (b) modelo equivalente de pequeña señal.

En las ecuaciones (2.5-2.7), se tiene que A_o es la ganancia del amplificador de voltaje, e $I_{N,AMP}^2$, el ruido referido al amplificador.

Si la prioridad es una alta sensibilidad, se usará un valor alto de R_F . De esta forma T_R aumenta, pero el BW disminuye. Sin embargo, en este caso la presencia de A_0 en el numerador del BW permitirá compensar la reducción de ancho de banda, debido al aumento de valor de R_F . Esta es la principal ventaja de usar este tipo de configuración [TAO06].

El otro tipo de preamplificador se basa en una amplificación en modo-corriente como etapa de entrada, combinada con alguna de las etapas intensidad-voltaje anteriormente comentadas, Fig. 2.12. La única ventaja que aporta es el aumento de BW, debido a la reducida resistencia de entrada. Sin embargo, presenta dos serios inconvenientes: los aumentos considerables de ruido y un mayor consumo de potencia [SAC05].

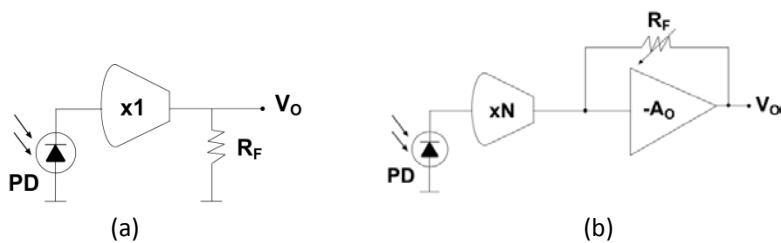


Fig. 2.12 Diagrama de Bloques de preamplificadores de modo corriente combinados con:
(a) Carga resistiva pasiva y (b) TIA.

Del análisis anterior se desprende que el preamplificador que proporciona un mejor compromiso entre T_R , BW y ruido, así como un moderado consumo, será un TIA.

Entre las diferentes implementaciones del TIA, se ha optado por diseñar la parte activa con una sola etapa. Con ello se consigue un menor coste, menor consumo, menor ruido y mayor estabilidad que con otras configuraciones de más etapas.

A la hora de elegir la implementación del TIA con componentes comerciales, el dispositivo más importante es el transistor. De entre las posibles tecnologías, las dos con una mayor versatilidad son la CMOS y la bipolar. Los transistores bipolares tienen un mayor ruido, pero también tienen un mayor factor de ganancia y, por lo tanto, el sistema debería mantener o favorecer la sensibilidad. Dado que no se ha encontrado en el mercado transistores CMOS comerciales para las frecuencias deseadas, la decisión final ha sido la elección de tecnologías bipolares. Se utilizarán transistores NPN por su mayor velocidad frente a los PNP.

Las implementaciones monoetapa consideradas son dos: la configuración emisor común y la configuración cascodo, ambas representadas en la Fig. 2.13.

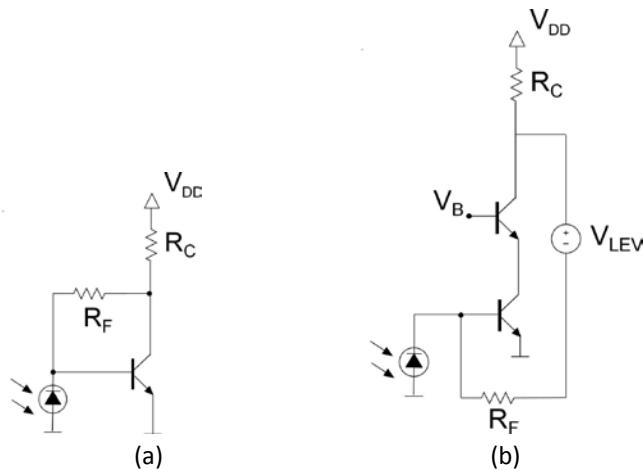


Fig 2.13 Configuraciones monoetapa: (a) emisor-común y (b) cascodo.

La segunda configuración impone un rango dinámico reducido a la salida. Esta característica hace que no sea adecuada para comunicaciones POF, pues la excursión de la señal de entrada varía considerablemente en función de la longitud de la fibra. Otra desventaja es su mayor coste, debido a que necesita una fuente de tensión flotante para desplazar el nivel en DC a la salida (V_{LEV}), así como el uso de un transistor extra.

Una característica muy importante de la etapa emisor-común es que se trata de una etapa autopolarizada, por lo que no se necesitará ningún voltaje de polarización (V_B) para el correcto funcionamiento del TIA.

Una condición de diseño impuesta al transistor bipolar del TIA es que sea de altas prestaciones, principalmente de una alta frecuencia de transición. La razón de esta condición es doble: validar las ecuaciones de primer orden previamente expuestas y simplificar el diseño del ecualizador. Esto se consigue gracias a que el polo introducido por el amplificador de tensión queda en frecuencias suficientemente mayores que la de operación, pudiendo modelar el amplificador de tensión como un bloque ideal. Por todo esto, la tecnología elegida ha sido la de Silicio-Germanio y el transistor utilizado es el BFP640, Infineon con *package* SOT-343 [Anexo III].

2.5.2. Diseño del Amplificador de Transimpedancia (TIA)

Una vez elegida la implementación de la etapa preamplificadora, el objetivo va a ser buscar el compromiso óptimo entre T_R , BW, ruido y consumo en potencia.

En primer lugar, debe establecerse un punto óptimo de polarización de la etapa. Para ello se analiza la estructura elegida (Fig. 2.13.a) y se fija de partida la corriente (I_C) y la tensión de colector (V_C). Posteriormente, se obtiene el valor de las resistencias en función de dichos parámetros. Este segundo paso es relativamente sencillo, y de hecho las expresiones (2.8) y (2.9) así lo demuestran. En la Fig. 2.14.a aparecen las magnitudes características del transistor y en la Fig. 2.14.b el valor de las resistencias, ambas obtenidas por simulación y en función de I_C .

$$R_C = \frac{V_{DD} - V_C}{I_C} \quad (2.8)$$

$$R_F = \beta \cdot \frac{V_C - V_{BE}}{I_C} \quad (2.9)$$

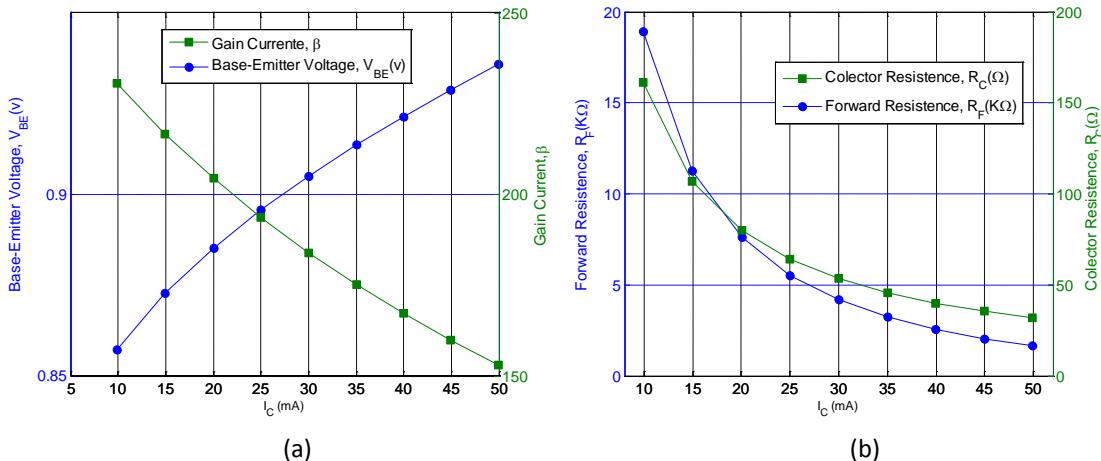


Figura 2.14 (a) Valores característicos del transistor BFP640, V_{BE} (azul) y β (verde). (b) Valores de las resistencias del TIA: R_F (azul) y R_C (verde). Todo ello en función de I_C y con $V_C=1.7$.

Sin embargo, la elección de I_C y V_C no es una tarea sencilla. Existen diversas condiciones de diseño que deben cumplirse simultáneamente. Por un lado, para asegurar un buen rango dinámico y un óptimo voltaje de polarización, tanto de esta etapa (preamplificador) como de la siguiente (ecualizador), se impone una $V_C \approx 1.7$ V. Y por otro lado, la elección de I_C exige un riguroso análisis de la *capability* del sistema. Este parámetro proporciona una figura de mérito (FOM) de la capacidad de transmisión del canal, tal y como se detalla en [VER03]. En la siguiente ecuación (2.10), se presenta dicho análisis:

$$C = BW \cdot \log_2 \left(\frac{i_{in} + (\bar{i}_{n,TIA}^2)^{\frac{1}{2}}}{(\bar{i}_{n,TIA}^2)^{\frac{1}{2}}} \right) \quad (2.10)$$

donde i_{in} representa la amplitud de la señal de entrada -tomando un valor estándar de $1\mu\text{A}$ - e $\bar{i}_{n,TIA}^2$ es el ruido referido a la entrada del TIA. Dicha magnitud es la FOM a optimizar, ya que tiene en cuenta todos los parámetros importantes involucrados en el diseño. Por todo ello, a continuación, se realiza un estudio teórico de los diferentes parámetros del TIA.

Si se aplica el modelo equivalente para pequeña señal [GRA10], Fig. 2.15, se puede calcular la transimpedancia (2.11), el ancho de banda (2.12), la impedancia de entrada (2.13) y el ruido referido a la entrada (2.14). Las principales fuentes de ruido son el ruido térmico que genera la R_F y el ruido *shot* debido a la corriente que circula por la base (I_B) [SÄC05]. En el análisis del ruido, hay que resaltar que los condensadores no contribuyen al ruido a menos que tengan una componente resistiva importante.

$$T_R(s \rightarrow 0) \approx (\beta \cdot R_{L1}) \parallel R_F \quad (2.11)$$

$$BW \approx \frac{1}{2\pi \cdot \left(\frac{C_d + C_{be}}{\beta} + C_{bc} \right) \cdot T_R} \quad (2.12)$$

$$Z_{in}(s \rightarrow 0) = \frac{\beta \cdot R_C \cdot R_F + R_C \cdot r_{be}}{r_{be} + R_F + R_C \cdot (\beta + 1)} \quad (2.13)$$

$$\bar{i}_{n,TIA}^2 \approx \left(\frac{4kT}{R_F} + 2qI_B \right) BW_n = \left(\frac{4kT}{R_F} + \frac{2qI_C}{\beta} \right) BW_n \quad (2.14)$$

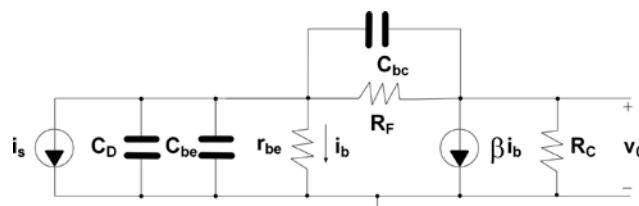


Fig. 2.15 Modelo equivalente para pequeña señal del TIA.

En las expresiones y modelos anteriores, r_{be} representa la resistencia base-emisor; C_{be} , la capacidad base-emisor; C_{bc} , la capacidad base-colector; y BW_n es el ancho de banda del ruido blanco referido a la entrada ($BW_n = 1.1 \cdot BW$).

El siguiente paso será calcular la *capability* (2.10) en función de I_C . Para ello, se utiliza el simulador eléctrico, debido a la complejidad de las dependencias con la corriente. En la Fig. 2.16 se representa de manera normalizada.

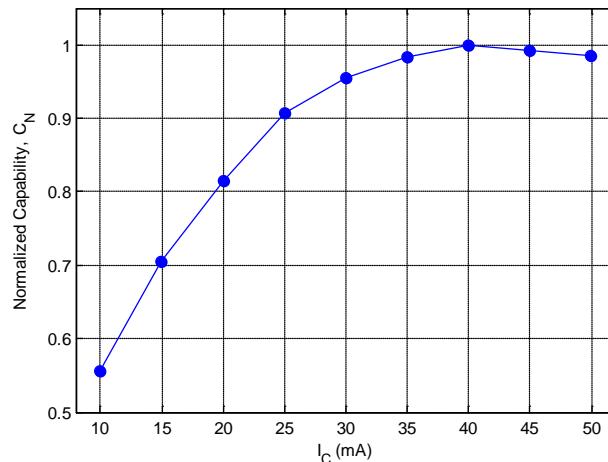


Fig. 2.16 *Capability* normalizada del TIA en función de I_C .

Se observa que la *capability* normalizada (C_N) es máxima para $I_C=40$ mA, pero la elección final ha sido $I_C=30$ mA. Esto se debe a dos motivos: a que se consigue un *matching* de 50Ω a la salida y a que el aumento de C_N no justifica el mayor consumo.

Como conclusión, el punto de polarización elegido es $I_C = 30$ mA y $V_{CE} \approx 1.75$ v. Las resistencias del TIA toman los valores de $R_F = 4$ k Ω y $R_{L1} = 50\Omega$. Las prestaciones obtenidas son: $T_R \approx 70$ dB Ω , $BW \approx 251$ MHz y $i_{n,TIA}^2 \approx 125$ nA_{rms} (referido a la salida, $V_{on,TIA}^2 \approx 410$ μ V_{rms}).

Para garantizar que el punto de polarización sea estable y que el fotodetector se pueda polarizar de manera independiente, se implementa la red de desacoplo mostrada en la Fig. 2.17. Para asegurar el correcto funcionamiento del preamplificador, se imponen dos importantes condiciones de diseño: 1) C_{DEC} debe ser suficientemente elevado como para que la constante de tiempo no influya en el comportamiento del circuito a altas frecuencias y 2) $R_{PD} \gg Z_{in}$. Según (2.13) tenemos una $Z_{in} \approx 100\Omega$. De esta forma, los valores elegidos son $C_{DEC}=22nF$ y $R_{PD}=2K\Omega$.

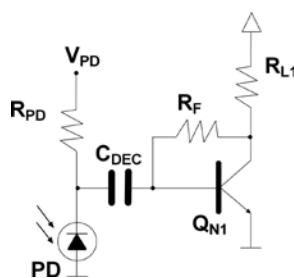


Fig. 2.17 Arquitectura del preamplificador propuesto.

2.6. Ecualizador

La distribución de este apartado tiene la misma estructura que la del preamplificador. En primer lugar, estudio del arte de las técnicas de ecualización y, a continuación, diseño analítico y por simulación de la opción elegida.

2.6.1. Análisis Etapas Ecualizadoras

El ecualizador es el bloque que corrige la limitación frecuencial debida a las características de la POF y al PD. La característica ideal de un EQ es que tenga una respuesta frecuencial inversa a la del canal, consiguiendo así que el sistema se comporte idealmente como un filtro paso-todo. A continuación se exponen los conceptos básicos de la ecualización.

El canal se modela de manera simplificada como un filtro paso-bajo con un polo dominante desplazado del origen, H_C (2.15); el objetivo del EQ es compensar la frecuencia asociada al polo (s_p) del canal, por lo que la respuesta ideal del ecualizador, $H_{EQ,i}$ (2.16), debe ser la inversa del canal. De esta forma se consigue un canal paso-todo en la respuesta del canal ideal ($H_{C,i}$), como queda representado en la Fig. 2.18 [SUN05].

Antes de continuar, resaltar que lo expuesto anteriormente es un caso ideal. En un caso real, la respuesta del ecualizador, $H_{EQ,r}$ (2.17), va a tener incluido al menos un polo intrínseco dominante (s_{intr}) y, por lo tanto, la respuesta global del canal, $H_{G,r}$ (2.18), más la del ecualizador tendrá un comportamiento típico paso-bajo. En la Fig. 2.18 se representa la respuesta frecuencial de un caso real de ecualización.

$$H_C(s) = \frac{A}{1 + \frac{s}{s_p}} \quad (2.15)$$

$$H_{EQ,i}(s) = \frac{1}{H_C(s)} = \frac{1}{A} \cdot \frac{1 + \frac{s}{s_p}}{1 + \frac{s}{s_z}} = A_{EQ} \cdot \left(1 + \frac{s}{s_z}\right) \quad (2.16)$$

$$H_{EQ,r}(s) = \frac{1}{H_C(s)} = A_{EQ} \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{s_z}\right)}{\left(1 + \frac{s}{s_{intr}}\right)} \quad (2.17)$$

$$H_{G,r}(s) = H_C(s) \cdot H_{EQ,r}(s) = \frac{A}{1 + \frac{s}{s_p}} A_{EQ} \cdot \frac{(1 + \frac{s}{s_z})}{(1 + \frac{s}{s_{intr}})} = \frac{1}{(1 + \frac{s}{s_{intr}})} \quad (2.18)$$

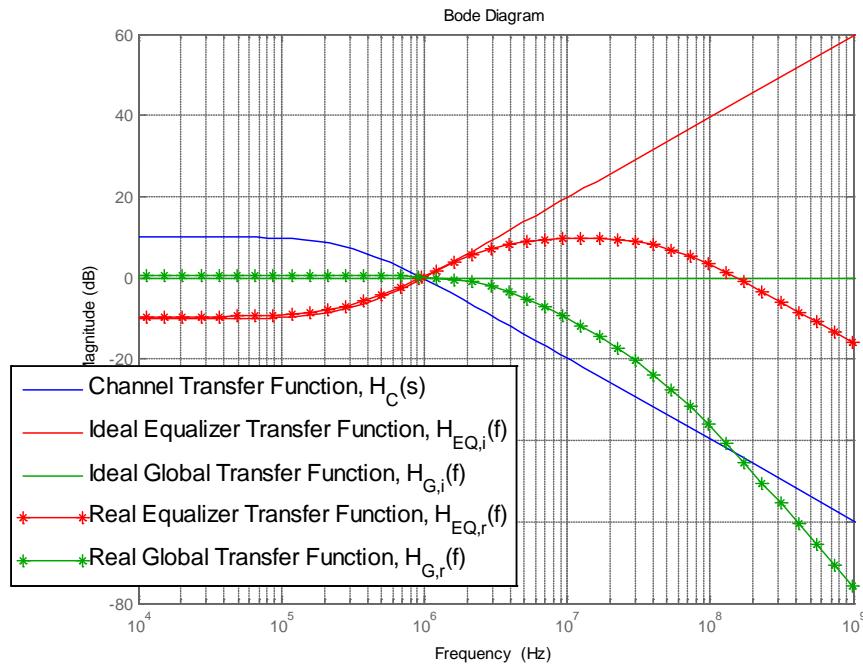


Fig. 2.18 Respuesta representativa del canal, ecualizador y respuesta global para el caso ideal y real.

Una vez introducidos los conceptos básicos, el siguiente punto es presentar las diferentes técnicas de ecualización. Para tener una visión global de las mismas se ha realizado un esquema de las diferentes implementaciones, teniendo en cuenta diversos criterios de diseño, Tabla 2.1.

La realización de una ecualización en el transmisor (EQ-TX) [HAR06] imposibilita la ecualización adaptativa necesaria en la POF. Los bajos niveles de señal hacen que un ecualizador pasivo (EQ-P) [MAX03] no resulte práctico. Y por último, utilizar los filtros FIR de alta velocidad como ecualizadores (EQ-FIR) [LEE01] incumpliría la condición de bajo coste y bajo consumo que perseguimos.

Tras este análisis teórico de las propuestas recogidas en la bibliografía, se llega a la conclusión de que la mejor elección es la ecualización de tiempo continuo en el receptor (EQ-CT). Esta opción es la que proporciona un mejor compromiso entre coste, consumo y adaptabilidad.

Ubicación	Técnica	Ventajas	Desventajas
Transmisor (EQ-TX)	De-énfasis	Fácil de aplicar. Filtros FIR usando bus de datos	No dispone información sobre el canal
	Pre-énfasis		
Receptor (EQ-RX)	Pasivo (EQ-P)	Consumo Nulo	Se necesita amplitud elevada de entrada y elevado SNR
	Tiempo Continuo (EQ-CT)	Compromiso entre consumo, coste y adaptabilidad	Escasa Programabilidad
	Filtros FIR (EQ-FIR)	Altamente adaptativo. Uso algoritmo como LMS, MSE, ...	Alta Complejidad. Necesidad ADC y S&H de alta velocidad

Tabla 2.1 Análisis de las Técnicas de Ecualización.

La técnica EQ-CT [LIU04] se basa en la división de la señal en dos caminos: uno en el que se amplifican las altas frecuencias mediante un filtro paso-alta y otro en el que se implementa un paso-todo. De esta forma se consigue un comportamiento de filtro paso-alto de ganancia variable. En la Fig. 2.19 se presenta su diagrama de bloques.

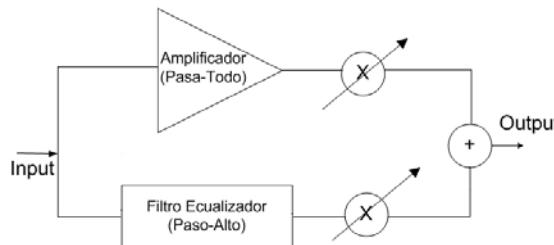


Fig. 2.19 Diagrama de bloques de un EQ-CT. La respuesta obtenida es un filtro paso-alta de ganancia variable.

En este trabajo, el anterior diagrama de bloques se implementa con la configuración mostrada en la Fig. 2.20. Dicha estructura está basada en una etapa diferencial con degeneración de fuente implementada en tecnología CMOS [AZN10, RAD05], con la que se obtiene también una relación señal a ruido (SNR) mejor. La topología será analizada con detalle en el siguiente apartado. Hay que destacar que variando los valores de la red del par degenerado (R_1, C_2, R_2) se modifica el comportamiento en frecuencia del ecualizador y que, de esta forma, se puede implementar una ecualización adaptativa. Un estudio sobre las técnicas de ecualización adaptativa se realiza en el anexo I.

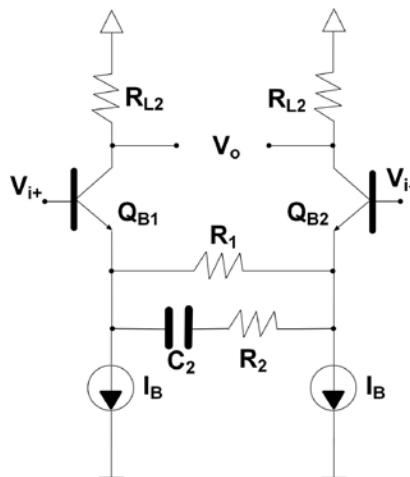


Fig. 2.20 Arquitectura del EQ propuesto: par diferencial con degeneración de fuente.

Para la implementación del circuito se ha optado por el uso de *arrays* de transistores en vez de transistores singulares. Los motivos de esta elección han sido el menor coste y el mejor *matching* entre los transistores que componen el *array*. Esta última ventaja asegura un funcionamiento más eficaz tanto del par diferencial como de los espejos de corriente. El *array* de transistores elegido ha sido el HFA3127, Intersil, compuesto por cinco transistores NPN y encapsulado SOIC [Anexo III].

2.6.2. Diseño del Ecualizador

Llegados a este punto, y al igual que se hizo con el TIA, debemos establecer un punto óptimo de polarización. Los criterios que se tienen en cuenta son: la correcta polarización de los espejos de corriente y maximizar la *capability* [VER03].

El primer paso es implementar las fuentes de corriente ideales. Se ha optado por la utilización de espejos de corriente en su estructura más sencilla. Esta configuración nos permite replicar de manera correcta la intensidad de polarización en ambas ramas.

El espejo de corriente, Fig. 2.21, consta de dos transistores, uno de ellos (Q_1) genera una intensidad de referencia ajustable dada por la ecuación 2.19, y el otro replica dicha corriente. Para asegurar su funcionamiento, es necesario que ambos trabajen en modo activo. Como el Q_1 se encuentra en configuración de diodo, siempre está en activa, por lo que sólo hay que asegurar que $V_{C2} \geq 0.2$ v. Se decide que $V_{C2} \approx V_{C1} \approx 0.8$ v. y de esta forma la réplica de corriente es más exacta [MAL03].

$$I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{BE1}}{R_B} \quad (2.19)$$

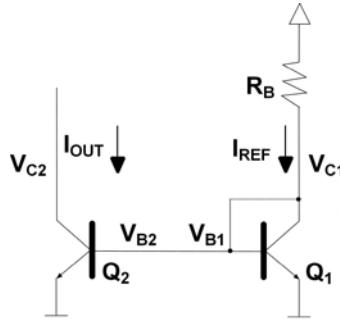
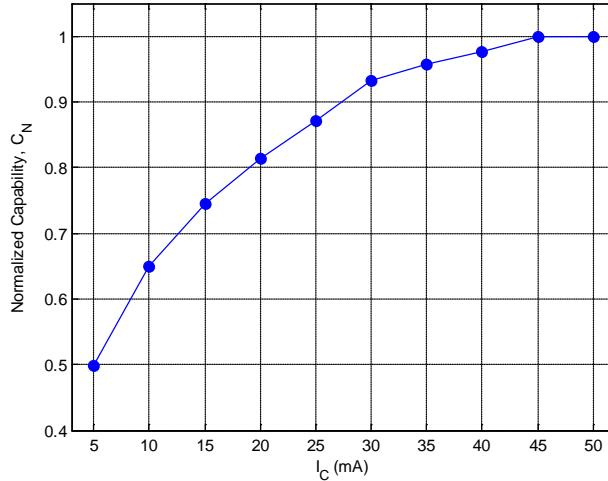


Fig.2.21 Esquema del espejo de corriente implementado.

Como se ha podido observar, el espejo de corriente nos impone un voltaje en el emisor de los transistores Q_{B1} y Q_{B2} , Fig. 2.20, de aproximadamente 0.8 V. Por esto, se decide que un voltaje óptimo para el colector de dichos transistores es $V_C = 1.75$ V. Con estas consideraciones lo que se consigue es que los voltajes colector-emisor de los transistores del par sean $V_{CE} \approx 1$ V.

El siguiente parámetro a fijar es la I_C , para lo cual se estudia inicialmente el par diferencial sin degeneración de fuente. Nuevamente, la magnitud a optimizar es la *capability* (2.10), pero en este caso se toma ruido unidad al no ser un parámetro crítico en esta etapa. Procediendo de la misma manera que con el TIA, los resultados de la *capability* normalizados son los mostrados en la Fig. 2.22.

Fig. 2.22 Capability normalizada del EQ en función de I_C .

Se puede observar que la máxima *capability* se alcanza con $I_C=50$ mA. Pero de nuevo nuestra elección será $I_C=30$ mA. Esta elección está justificada por dos razones: 1) con el valor de corriente escogido se obtiene una $R_{L1} \approx 50 \Omega$ y por lo tanto el *matching* de salida está asegurado y 2) un aumento en el consumo del 66 % apenas supone una pérdida del 5% de *capability*. Con el par diferencial polarizado con $I_C = 30$ mA y $V_{CE} \approx 1$ V, se tiene que $R_B = 70 \Omega$, $G \approx 17$ dB y $BW \approx 600$ MHz.

Una vez seleccionado el punto de operación, se procede a diseñar la red de ecualización. Para ello se aplica el modelo equivalente para pequeña señal, Fig. 2.23, y se obtiene la función de transferencia y las impedancias de entrada y salida. Las expresiones de dichas magnitudes son las ecuaciones 2.20, 2.21 y 2.22 [GRA10]. Si se analiza la función de transferencia, se aprecia la aparición de un polo y un cero, que es precisamente la que se espera de un ecualizador.

$$H(s) \approx \frac{\beta R_L}{r_{be} + (\beta + 1)R_1} \cdot \frac{1 + sC_1(R_1 + R_2)}{1 + s \frac{C_1(r_{be}(R_1 + R_2) + (\beta + 1)R_1R_2)}{r_{be} + (\beta + 1)R_1}} \quad (2.20)$$

$$Z_{in}(s \rightarrow 0) \approx r_{be} + (\beta + 1)R_1 \quad (2.21)$$

$$Z_o(s \rightarrow 0) \approx R_{L1} \left\| r_o \cdot \left(\frac{r_{be} + (\beta + 1)R_1}{r_{be} + R_1} \right) \right\| \quad (2.22)$$

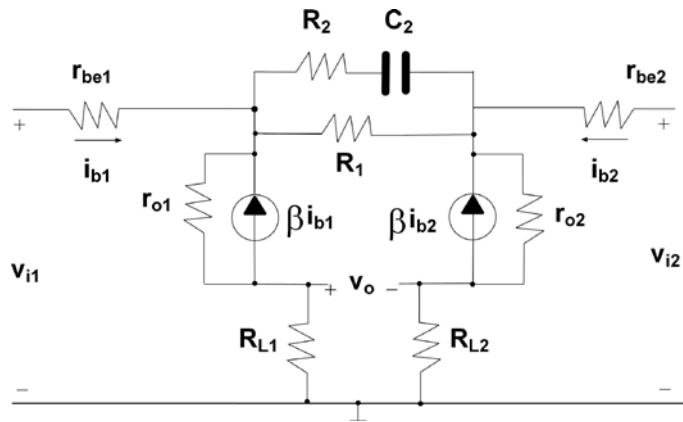


Fig. 2.23 Modelo equivalente de pequeña señal del EQ.

En estas ecuaciones y en el modelo, aparece r_{oi} que se corresponde con la resistencia de colector-emisor. Debido a su alto valor sólo influye en el cálculo de la impedancia de salida.

Uno de los parámetros más importantes en esta red es precisamente R_1 , ya que determina no sólo la ganancia e impedancias sino también la localización de los polos y los ceros del sistema. Dada la complejidad para poder obtener un compromiso analítico, se ha realizado un detallado análisis por simulación [ATT02]. Finalmente, el valor que se ha tomado ha sido $R_1=220 \Omega$. Este valor proporciona un correcto *matching* a la salida de 50Ω y una impedancia de entrada lo suficientemente elevada. Asimismo, las reducidas pérdidas que introduce R_1 hacen que $G \approx -10 \text{ dB}$, lo que proporciona una ganancia total del sistema, teniendo en cuenta el TIA, de 60 dB . Por otra parte, con valores adecuados para esta aplicación de $C_2=3$ a 12 pF y $R_2=0$ a 15Ω , el ajuste de polos y ceros por simulación es el apropiado. En la Fig. 2.24 se presenta la arquitectura final del EQ.

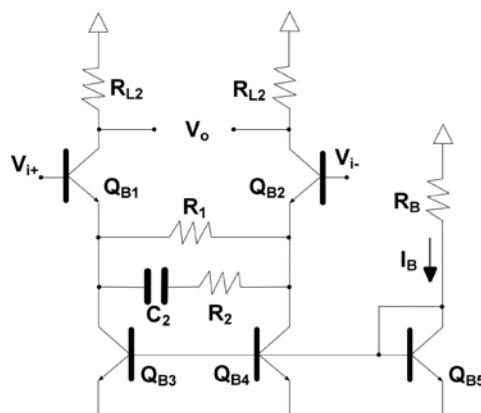


Fig. 2.24 Esquemático del EQ propuesto.

3

Caracterización experimental

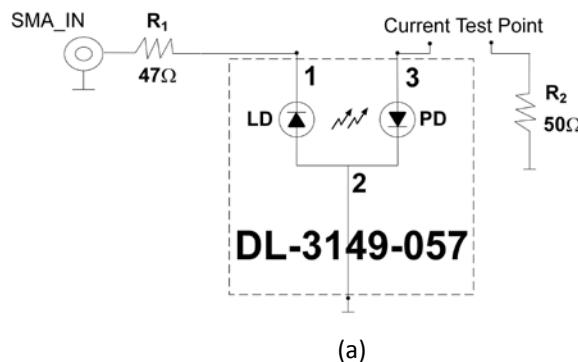
- 3.1. Transmisor
- 3.2. *Front-End* del Receptor
- 3.3. Caracterización Experimental del Sistema Completo

La organización de este capítulo es la siguiente: en el primer apartado, se presenta la PCB, el *setup* y las medidas del LD. En el apartado siguiente, se detalla la PCB implementada para el *front-end*. En el último, se explican las configuraciones necesarias para la caracterización del sistema completo y se exponen los resultados experimentales.

3.1. Transmisor

El objetivo de esta PCB es poder generar una señal de excitación óptica utilizando el láser semiconductor DL-3149-057, Sanyo. Lo primero a tener en cuenta es que el equipo de test está formado por dispositivos con la necesidad de *matching* a $50\ \Omega$ y que, en condiciones estables de operación, el láser presenta una resistencia de 2-3 Ω . Por lo tanto, para conseguir un buen *matching*, la PCB incluye una resistencia de $47\ \Omega$ en serie.

También hay que considerar que el LD incorpora monolíticamente un fotodiodo que proporciona una corriente de monitorización. Esta corriente de test permite corroborar el correcto funcionamiento del dispositivo, por lo que se deja dispuesto un punto para su medida. En este punto de medida se utilizan *jumpers*, mientras que para introducir la señal de excitación del láser la conexión se realiza a través de conectores SMAs, que proporcionan una respuesta plana hasta 3 GHz. El esquemático de la PCB se muestra en la Fig. 3.1.a y su implementación en la Fig. 3.1.b.



(a)



(b)

Fig. 3.1 LD: (a) Esquemático de la PCB y (b) implementación.

En la Fig. 3.2 se presenta el *setup* de medida. Como se puede observar, incluye un *bias-T* (ZFBT-4R2G+, Minicircuits) [Anexo III]. La necesidad de este dispositivo es doble. La primera, proporcionar la tensión en DC inversa necesaria para la correcta polarización del LD, utilizando una fuente externa de voltaje. La segunda, que será presentada en el apartado 3.3, tiene que ver con la superposición de la componente en señales. Las características en DC son medidas con un multímetro de precisión (Multimeter 3458A, Agilent) [AGI01]. La emisión del LD se evalúa con un medidor de potencia para fibra óptica (FM300, Fotec m) [FOT00].

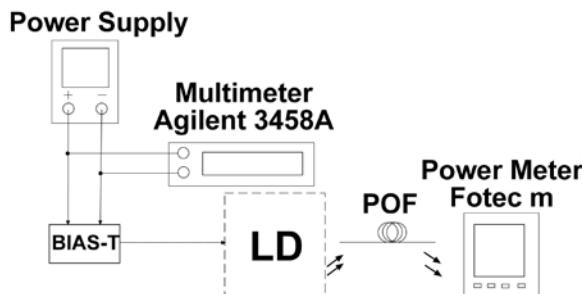


Fig. 3.2 *Setup* para la caracterización del láser.

Con el *setup* anterior, se mide la relación entre la potencia óptica emitida (P_{opt}) y el voltaje aplicado en inversa (V_{BF}), lo que proporciona la denominada recta de carga, Fig. 3.3. De esta forma se obtiene la información necesaria para polarizar correctamente el láser. El punto de polarización elegido es $V_{\text{BF}} = 4$ V. Según las especificaciones del láser, la corriente máxima que soporta es 45 mA y la corriente umbral es 25 mA; estos valores se alcanzan con voltajes de 4.6 y 3.4 V, respectivamente. Lo que justifica que el punto elegido, $V_{\text{BF}} = 4$ V, esté en el punto medio de la recta de carga.

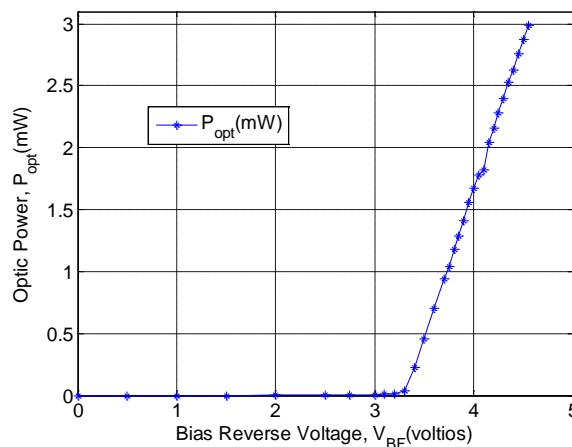


Fig. 3.3 Recta de carga experimental del *red laser diode* DL 3149-057.

3.2. *Front-end del receptor.*

La Fig. 3.4 muestra el esquemático del *front-end* donde los componentes discretos son los mencionados en apartados anteriores. Los componentes pasivos -resistencias y condensadores- son SMDs 0603 (Surface Mount Device). Esto asegura bajos efectos parásitos para las frecuencias de trabajo. Estructuras similares son tratadas en diferentes casos [OHH99, ANA02, GON07, BAN08].

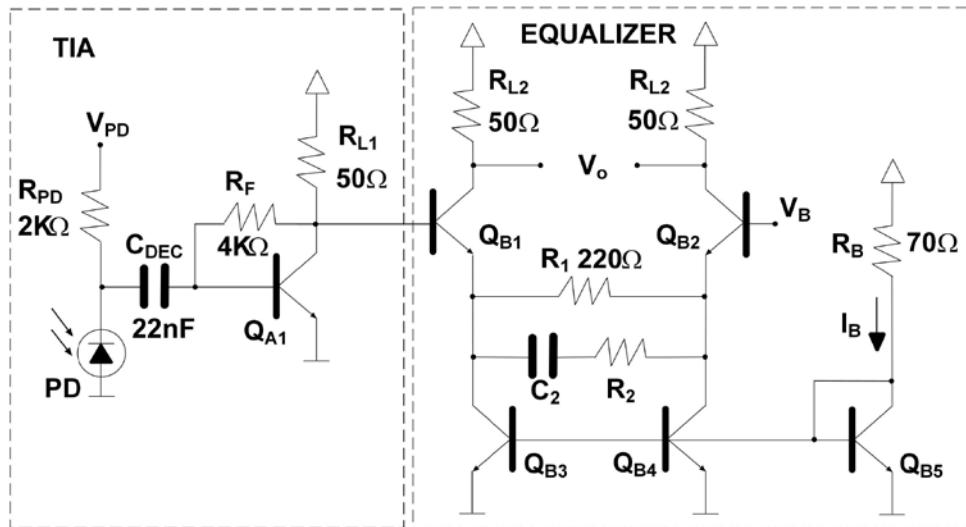


Fig. 3.4 Arquitectura del *front-end* completo.

La PCB que contiene el *front-end* ha sido fabricada en el Servicio de Instrumentación Electrónica de la Universidad de Zaragoza. Antes de pasar a comentar las características básicas y reglas de diseño que se han aplicado, hay que resaltar que muchas de ellas se basan en intentos previos y en la experiencia acumulada por el Grupo de Diseño Electrónico (GDE).

Una de las primeras decisiones que se debe tomar hace referencia a cómo se distribuyen el plano de masa, la señal y la alimentación en la PCB. En este caso, se aplica un diseño de doble cara en el que la cara *bottom*, Fig. 3.7.a, es un plano de masa uniforme, y la *top*, Fig. 3.7.b, contiene los caminos de señal y alimentación. A continuación, se exponen los motivos que nos ha llevado a optar por esta distribución.

La decisión de tener un plano uniforme de masa viene determinada por la minimización del ruido producido y por el desacoplamiento que introduce. Esta decisión se ha basado en intentos anteriores en los que, a pesar de implementar cortes pequeños en el plano de masa con una pequeña divergencia de la corriente de retorno, el ruido aparecido era considerablemente mayor que el teórico. Con el plano uniforme de masa se obtienen dos ventajas: 1) La reducción de ruido que se produce cuando se tiene señales de alta velocidad, debida a que se asegura la impedancia mínima de

retorno. 2) Que proporciona un desacoplo efectivo a partir de 100 MHz [MON99, VER06] porque el plano de masa y las pistas de alimentación presentan una capacidad parásita del orden del nF.

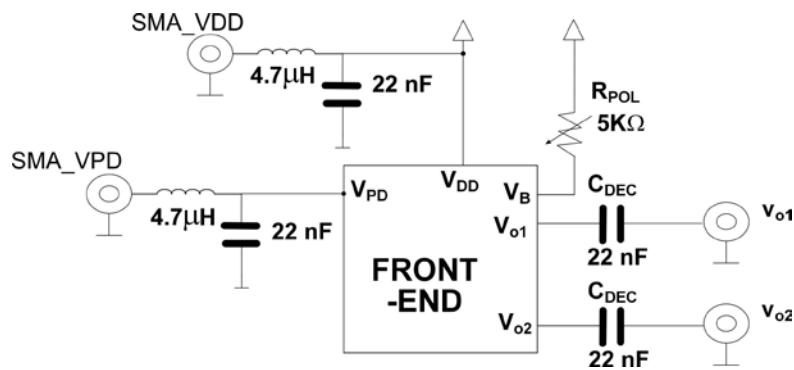
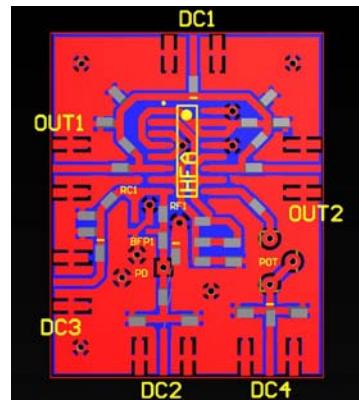
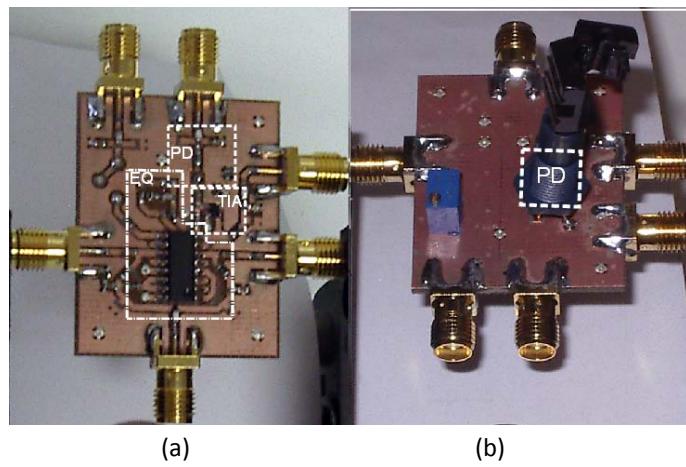
Por otro lado, para el correcto funcionamiento de la PCB se deben integrar en la misma: una red de filtrado de alimentación, una red polarizadora del transistor Q_{B2} y las etapas de desacoplo, Fig 3.5.

Como se puede apreciar en la Fig. 3.5, la red de filtrado de alimentación consta de un inductor de ferrita con valor de $4.7 \mu\text{H}$ y un condensador de desacoplo de 22 nF . El tanque que forman proporciona un filtrado correcto para frecuencias medias y altas, con atenuaciones superiores a 20 dB para frecuencias por encima de los 10 MHz [VER06]. El inductor utilizado presenta un encapsulado SMD 0805 con una capacidad parásita reducida, y soporta corrientes de hasta 180 mA . Por otra parte, el condensador de desacoplo utilizado es de tipo multicapa cerámico de dieléctrico X7R y de encapsulado SMD 0603. Este tipo de condensadores presenta una baja inductancia parásita y baja resistencia parásita. Hay que destacar que, en intentos anteriores, la adición de condensadores de desacoplo de rangos de valores diferentes no ha proporcionado ninguna ventaja significativa.

Respecto a la polarización del transistor Q_{B2} , se ha decidido la inclusión de un potenciómetro, Fig. 3.5, que regule la intensidad de base. De esta forma se consigue un ajuste más fino del punto de polarización óptimo. Para tomar esta decisión, se ha tenido en cuenta que en otras PCBs se optó por fijar una tensión de referencia mediante un *dummy* del TIA. Esta opción presentó malas prestaciones debido a un reducido *matching* entre los dos transistores BFP640, así como un aumento de consumo y de coste. Más concretamente, con el potenciómetro se consumen $400 \mu\text{A}$ frente a 30 mA con el *dummy* del TIA y, además, se ahorra el uso de un transistor extra [SPE97].

La conexión de las señales con los equipos de test se realiza a través de SMAs que proporcionan una respuesta plana hasta los 3 GHz . También se incluye un condensador de desacoplo (C_{DEC}) de 22 nF para evitar la despolarización de la estructura, Fig. 3.5.

Por otra parte, son reglas de diseño básicas en el trazado de pistas: buscar la longitud mínima de las mismas, realizar trazados lo más rectos posible -nunca trazados de 90 grados en las pistas-, ubicar la red de filtrado lo más cerca posible del circuito y evitar bucles en los trazado. Estas reglas se han aplicado de manera sistemática en la implementación de todas las PCBs [MON99, KHA06]. En la Fig. 3.6, se puede apreciar el trazado de pistas realizado en la versión definitiva.

Fig. 3.5 Esquemático de la PCB del *front-end*.Fig. 3.6 Trazado pistas cara *top* del *front-end*.Fig. 3.7 PCB *front-end* implementado: (a) *top* y (b) *bottom*.

3.3. Caracterización Experimental del Sistema Completo

La caracterización experimental considera el sistema completo formado por el TX, las POFs de diferentes longitudes y el *front-end*. Los diagramas de bloques de las diferentes configuraciones son presentados en las Figs. 3.9.a y 3.9.b. Como se puede observar, una ventaja muy interesante es que, con pequeñas modificaciones del mismo *setup*, Fig. 3.8, se puede configurar tanto para medir respuestas frecuenciales, Fig. 3.9.a, como para visualizar y analizar transmisiones de datos digitales, Fig. 3.9.b.

La señal de entrada al LD está compuesta por una componente en DC (detallada en la sección 3.1) y por otra componente en AC que excita al láser. La señal AC, en el caso del análisis en frecuencia es generada por el analizador de redes (ZVL 9 kHz/6 GHz, R&S). Como el analizador solo permite una entrada, la señal de salida diferencial del *front-end* se pasa a modo único con el uso de un balun (Model Bib-100G, Prodyn [Anexo III]).

Por otro lado, si se pretende caracterizar una transmisión de datos POF, la señal AC es una señal PRBS generada por el medidor de tasa de error (BERT N4906A, Agilent). A diferencia de lo que ocurre en el *setup* anterior, el análisis de las señales de salida se realiza con otro dispositivo: un analizador de comunicaciones digitales (DCA 86100 C, Agilent). Dicho dispositivo representa y analiza señales periódicas PRBS. Hay que notar que, para el correcto funcionamiento del DCA, hay que suministrárle una señal de sincronismo. En este caso, esta señal proviene del reloj del BERT (CLK).

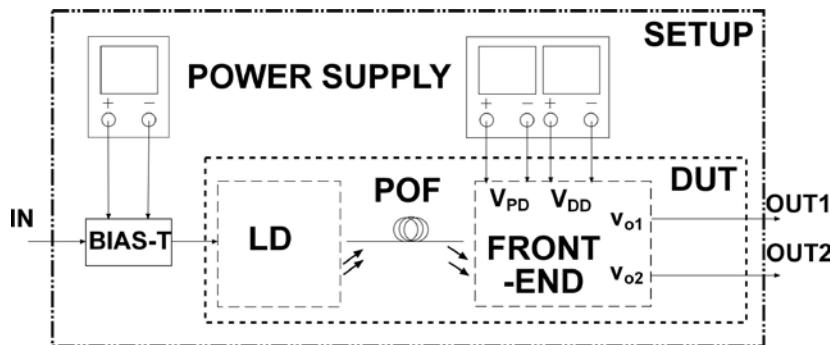


Fig. 3.8 *Setup* de medida del circuito bajo test (DUT).



Fig. 3.9 Configuraciones caracterización del sistema completo: (a) Respuesta frecuencial y (b) Transmisión de datos.

En primer lugar, se han corroborado las diferentes medidas en DC del sistema, utilizando el multímetro de precisión 3458A, Agilent. Ha sido en este momento cuando se ha realizado un ajuste fino del potenciómetro (R_{POL}) y, así, asegurar que las tensiones del transistor Q_{B2} replican las de Q_{B1} . También se ha medido el consumo: 396 mW, un valor prácticamente igual al calculado teóricamente.

Para obtener la respuesta frecuencial ecualizada para diferentes longitudes de fibra, se llevó a cabo el procedimiento siguiente. Primero, se midió la respuesta del sistema completo sin ecualizar. Esto se consigue simplemente no incluyendo C_2 y R_2 en el sistema de la Fig. 3.4. Y posteriormente, mediante un método de prueba y error, basado en una comparativa entre los resultados de simulación y los experimentales, se obtienen los diferentes valores de R_2 y C_2 . Así se obtiene una relación R_2-C_2 en función de la longitud de la fibra. En este trabajo, las diferentes redes ecualizadores se han soldado y dessoldado manualmente. Sin embargo, hay que destacar que, en una futura versión definitiva, todas las redes estarán presentes y serán seleccionadas electrónicamente mediante un control adaptativo.

Procediendo de la manera explicada, los resultados experimentales que se obtienen son los mostrados en la Fig. 3.10. En estos resultados, se presentan tanto aquellos obtenidos antes como después de la inclusión de R_2-C_2 . Cuantitativamente se obtiene un aumento del BW entre 3.7 y 4.6 veces en función de la longitud de la fibra, siendo aproximadamente 90 MHz el mejor de los casos analizados (longitud de 10 m). Sin embargo, tras incluir los dispositivos ecualizadores, la frecuencia de corte a la salida del sistema se mantiene prácticamente constante y con un valor de 340 MHz. De aquí se deduce que, con esas redes, el sistema está preparado para operar como posible ecualizador adaptativo [LOP10]. Por otro lado, se pudo comprobar experimentalmente que la frecuencia inferior de corte era muy similar tanto en el caso de estructura sin ecualizar como en la ecualizada, obteniéndose 150 kHz.

Las Figs. 3.11, 3.12 y 3.13 representan los diagramas de ojo [DER08] obtenidos para las diferentes longitudes de fibra y para las redes ecualizadoras correspondientes. Todos ellos consideran la misma potencia óptica del láser, una secuencia PRBS de $2^{31}-1$, y una tasa de 800 Mbps compatible con el estándar IEEE 1394. Los resultados obtenidos muestran que: 1) la apertura del ojo varía entre 3 y 24 mV, para fibras de longitud comprendida entre 30, 20 y 10 m respectivamente. 2) El BER obtenido para todos los casos está por debajo de 10^{-12} . Y 3) El peor caso de jitter es 170 ps_{rms} (12% del tiempo de bit) y se obtiene para la fibra de 30 metros [LOP10].

También se ha realizado un análisis del ruido del sistema. Esta medida la proporciona el propio DCA. En la Fig. 3.14, queda representada la distribución del ruido en función del estado lógico 1/0. El máximo ruido detectado se da en el estado lógico “1” y con un

valor de $614 \mu\text{V}_{\text{rms}}$. El modelo teórico, que se presentó en la sección 2.5.2, predice una contribución de ruido en torno a $410 \mu\text{V}_{\text{rms}}$. Este error del 33% entre resultados teóricos y de simulación puede estar asociado a un aumento de la temperatura del sistema y/o a un mayor ruido ambiental. Sin embargo, dada la simplicidad del modelo, se considera que los resultados son consistentes.

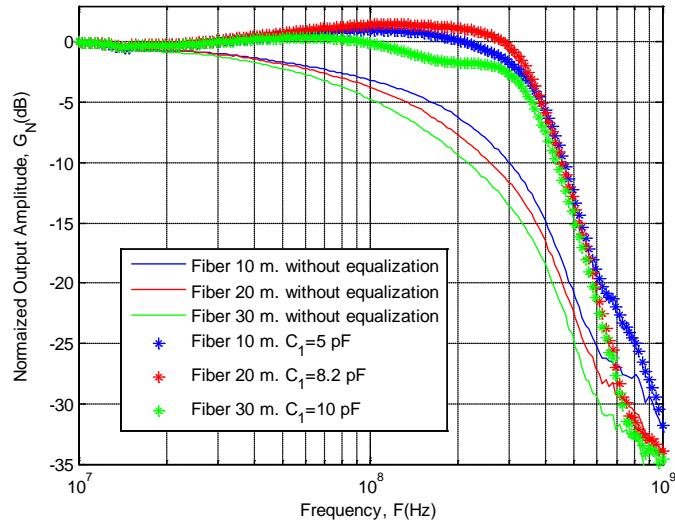


Fig. 3.10 Respuesta frecuencial del sistema POF.

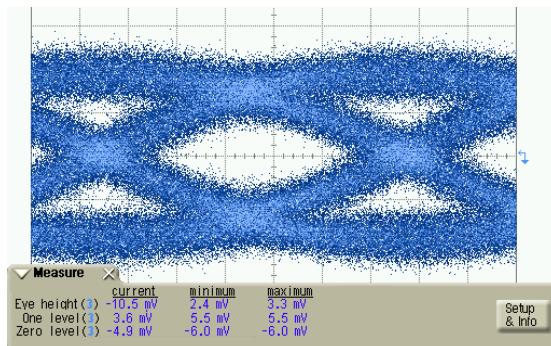


Fig. 3.11 Diagrama de ojo para $2^{31}-1$ NRZ PRBS.

$R_1=220 \Omega$, $R_2=5 \Omega$, $C_2=10 \text{ pF}$.

Longitud de fibra 30 m y tasa 800 Mb/s.

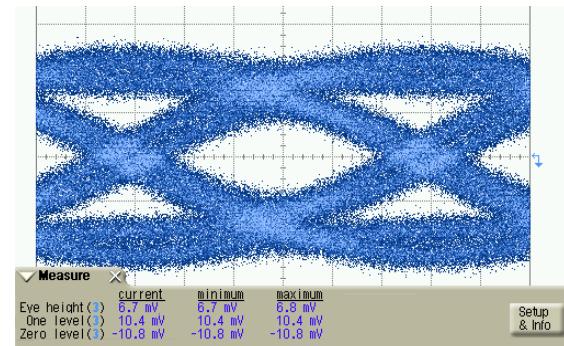


Fig. 3.12 Diagrama de ojo para $2^{31}-1$ NRZ PRBS.

$R_1=220 \Omega$, $R_2=5 \Omega$, $C_2=8.2 \text{ pF}$.

Longitud de fibra 20 m y tasa 800 Mb/s.

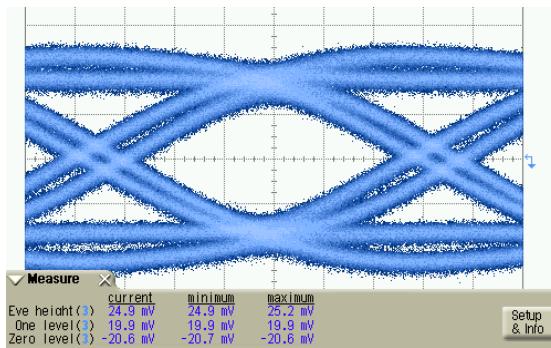


Fig. 3.13 Diagrama de ojo para $2^{31}-1$ NRZ PRBS.

$R_1=220 \Omega$, $R_2=5 \Omega$, $C_2=5 \text{ pF}$.

Longitud de fibra 10 m y tasa 800 Mb/s.

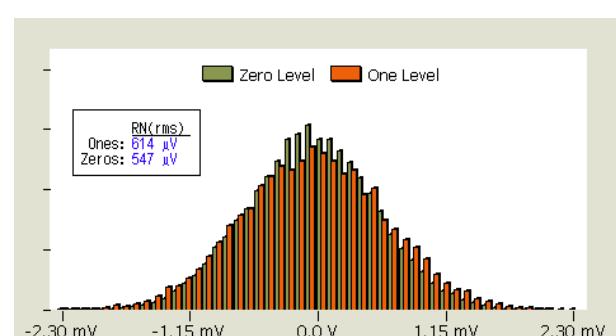


Fig. 3.14 Distribución del ruido en función del estado lógico "1/0".

4

Conclusiones

- 4.1. Conclusiones Generales
- 4.2. Líneas Futuras
- 4.3. Valoración Personal

Tras proceder a una recapitulación del trabajo realizado, se presentan las prestaciones finales obtenidas, se exponen posibles líneas futuras de investigación y finalmente, se realiza una valoración personal.

4.1. Conclusiones Generales

Este trabajo ha consistido en el estudio, análisis, simulación, implementación y caracterización de un sistema óptico de banda ancha POF. El objetivo del mismo ha sido la realización de un ecualizador analógico que compense la limitación frecuencial de la POF.

Se ha realizado un estudio detallado de todos los elementos del sistema, lo que ha permitido la elección de los componentes y de las estructuras más adecuadas; y se ha llevado a cabo el diseño electrónico de un TIA y de un EQ, basado en un estudio analítico y en los resultados obtenidos por simulación eléctrica. Todo lo anterior ha tenido como finalidad desarrollar un método de diseño que permita optimizar de manera sistemática y reproducible las prestaciones de dicho sistema óptico. Hay que resaltar que en todo momento se ha aplicado la condición de bajo coste, requisito imprescindible de los sistemas basados en POFs. Así como la búsqueda de un compromiso entre ganancia, BW, ruido y consumo.

Se describen detalladamente las PCBs realizadas y las consideraciones de diseño más importantes en su implementación. Asimismo, se realiza la caracterización experimental del sistema, explicando los *setups* de medida necesarios y los resultados obtenidos. De todo ello se deduce que el sistema desarrollado puede operar como un eficiente ecualizador.

Las prestaciones finales obtenidas, aplicando las diferentes redes ecualizadoras, permiten una transmisión a 800 Mbps compatible con el estándar IEEE 1394 para las diferentes longitudes de fibra: de 10, 20 y 30 metros. En todos los casos, el BER está por debajo de 10^{-12} y el peor *jitter* es 170 ps_{rms} (12% del tiempo de bit).

En la Tabla 4.1, se realiza una comparación con los sistemas SI-POF implementados por otros autores, donde la FOM es la *capacity* del sistema, medida en Mbps·Km.

Ref.	Instituto	Tasa (Mbps)	Capacity (Mbps·Km)	Emisor
[NEH06]	Euromikron	125	14	655 nm LED
[JUN04]	Fraunhofer IIS	500	25	650 nm DVD-LD
[ZIE05]	POF-AC	820	16.4	650 nm LD
Nuestro Trabajo	Univ. Zaragoza	800	24	670 nm LD

Tabla 4.1 Comparativa con otros autores.

4.2. Líneas Futuras

En este PFC se ha desarrollado un sistema óptico para POF, demostrando que la etapa ecualizadora puede compensar las limitaciones frecuenciales de la POF y que puede operar como ecualizador adaptativo. Esto abre las siguientes líneas de trabajo e investigación:

- Uno de los primeros pasos a dar en el futuro será la implementación de un sistema electrónico que nos permita elegir la red ecualizadora. Para ello, una opción a tener en cuenta será la implementación de *switches* de alta velocidad, de esta manera, a través de ellos se elegiría la red adecuada. Otra opción bajo estudio, sería la colocación de transistores CMOS en configuración de resistencia o condensador variable, por lo que el valor de la red se controlaría directamente mediante voltajes externos.
- Un reto que se plantea, una vez demostrada la viabilidad de la estructura como ecualizador reconfigurable electrónicamente, es realizar un lazo de realimentación que permita adaptar el sistema automáticamente según la longitud y características de la fibra. Esto implica un estudio exhaustivo del sistema, así como el diseño de filtros, rectificadores y amplificadores de error. Todo ello manteniendo las condiciones iniciales de diseño, especialmente la de bajo coste.
- Por otro lado, una opción interesante sería la de aplicar técnicas de *shunt peaking* [ANA04], tanto en el TIA como en el EQ. Esta técnica puede proporcionar un relativo aumento del BW. Siendo la más innovadora su aplicación en la red ecualizadora, por lo que la red implementada estaría compuesta por inductores y condensadores (C_2-L_2).
- Una línea de investigación abierta dentro del Grupo de Diseño Electrónico es la de implementar un *front-end* completo, introduciendo el Amplificador Limitador (LA) en el diseño. De esta forma, con un diseño conjunto, la optimización sería mayor, obteniendo un *front-end* de altas prestaciones [GAR10].

4.3. Valoración Personal

El trabajo realizado me ha permitido profundizar en todos los pasos necesarios en un proceso de diseño electrónico: diseño analítico, simulación, diseño e implementación de PCBs y caracterización experimental.

Igualmente, me ha dado la oportunidad de familiarizarme con las diversas herramientas que se utilizan en dicho proceso de diseño: programación SPICE como simulador eléctrico, Altium Designer para la implementación de PCBs, así como, el conocimiento de la instrumentación necesaria para caracterizar circuitos electrónicos.

El contexto de este PFC, integrado en líneas de investigación del GDE y del GTF, me ha supuesto un complemento instructivo de alto valor, así como una iniciación en las técnicas de investigación. Parte del trabajo realizado en este PFC y de la colaboración en otros proyectos con los miembros del GDE y del GTF ha quedado reflejada en la publicación de tres artículos: [LOP10] Aceptado en la *19th International Conference on Plastic Optical Fibers* 2010, [GAR10] Publicado en la revista *Microelectronics Reliability* 2010 y [AZN10] en el congreso internacional *IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems* 2010.

Todo lo anterior, la profundización en los pasos de un proceso de diseño, la iniciación en las técnicas de investigación y la familiarización con las diversas herramientas, hace que todas las expectativas en la realización del PFC se hayan cumplido. Pero lo que más satisfacción me ha proporcionado ha sido el poder colaborar y trabajar con los compañeros de GDE y del GTF, y es ahí donde mi formación y preparación más ha crecido.

Referencias

- [AGI01] Agilent Technologies, “*User’s Guide: Agilent 3458A Multimeter*”. <http://www.agilent.com/>, March 2001.
- [AGI05] Agilent Technologies, “*User’s Guide: Agilent N4906B Serial BERT*”. <http://www.agilent.com/>, October 2005.
- [AGI08] Agilent Technologies, “*Agilent 86100A/B/C Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe Service Guide*”. <http://www.agilent.com/>, November 2008.
- [ALT09] Altium Designer, “*Altium Designer Training for Schematic Capture and PCB Editing*”. <http://www.altium.com/training/en/manuals-and-downloads.cfm>, 2009.
- [ANA02] B. Analui and A. Hajimiri, “*Multi-Pole Bandwidth Enhancement Technique for Trans-impedance Amplifiers*”. ESSCIR, 2002.
- [ANA04] B. Analui and A. Hajimiri, “*Bandwidth Enhancement for Transimpedance Amplifiers*”. IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 39, No.8 , August 2004.
- [ARA10] L. A. Araque, “*Comunicaciones con Fibra Óptica, Fibra Monomodo*”. <http://conocimientosdwdmtechnology.blogspot.com>, June 2010.
- [ATT02] J. O. Attia, “*Pspice and Matlab for Electronics – An Integrated Approach*”. CRC Press, 2002.
- [AZN10] F. Aznar, S. Celma, B. Calvo and I. Lope, “*A 0.18 μ m CMOS Integrated Transimpedance Amplifier-Equalizer for 2.5 Gb/s*”. IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems. Seattle, 2010.
- [BAB98] J.N. Babanezhad, “*A 3.3 V Analog Adaptive Line-Equalizer for Fast Ethernet Data Communication*”. Proc. IEEE Custom Integrated Circuits Conf., pp. 343-346, 1998.
- [BAN08] S. Bandyopadhyay, P. Mandal, S. E. Ralph and K. Pedrotti, “*Integrated TIA-Equalizer for High Speed Optical Link*”. 21st International Conference on VLSI Design (VLSI Design 2008), pp. 208-213. Hyderabad, 2008.
- [DER08] D. Derickson, M. Müleer, “*Digital Communications Test and measurement – High Speed Physical Layer Characterization*”. Prentice Hall, 2008.
- [FIR06] Firecomms Ltd., “*Firecomms publishes reliability data on RCLED and VCSEL products*”. Press Room, Cook, Ireland, October 2006.
- [FOT00] Fotec, “*Smart Fiber Optic Instruments and Test Kits*”. http://www.testmart.com/webdata/mfr_pdfs/FOTEC/FOTEC%28smarttestkits.pdf, 2000.

- [GAR08] J. I. Garcés and J. Mateo, "Apuntes Comunicaciones Ópticas". Universidad de Zaragoza, <http://diec.unizar.es/asignaturas>, 2008.
- [GAR10] J. M. García del Pozo, S. Celma, A. Otín, I. Lope and J. Urdangarín. "1.8V - 3GHz CMOS Limiting Amplifier with Feedforward Frequency Compensation". Microelectronics Reliability, 2010.
- [GIO03] G. Giacomelli, "Experimental study of stochastic phenomenon vertical cavity lasers". <http://www.fi.isc.cnr.it/users/giovanni.giacomelli/>, 2003
- [GON07] S. Gondi and B. Razavi, "Equalization and Clock Data Recovery Techniques for 10-Gb/s CMOS Serial-Link Receivers". IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 42, No.9 , September 2007.
- [GRA10] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis and R. G. Meyer, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits". John Wiley and Sons, Inc., 5th edition., 2010.
- [HAR06] R. Harjani, "Design of High-Speed Communication Circuits". World Scientific 2006.
- [ING04] M. Ingels, M. Steyaert, "Integrated CMOS Circuits for Optical Communications". Advanced Microelectronics, Springer, 2004.
- [JUN04] S. Junger, B. Offenbeck, W. Tscheikalinskij and N. Newer, "IEEE 1394 transmission with SI-POF at 800 Mbit/s". Invited Paper, POF'2004, Nuremberg, pp 225-231, September 2004.
- [KHA06] R. S. Khandpur, "Printed Circuit Board – Design, Fabrication and Assembly". McGraw-Hill, 2006.
- [LEE01] T.-C. Lee, B. Razavi, "A 125-MHz CMOS Mixed-Signal Equalizer for Gigabit Ethernet on Copper Wire". Proc.IEEE Custom Integrated Circuits Conf., pp. 131-134, 2001.
- [LIU04] Jin Liu and Xiaofeng Lin, "Equalization in High-Speed Communication Systems". IEEE Circuits and Systems Magazine, Vol 4, NO 2, pp.4-17, 2004.
- [LOP10] I. Lope, J. Mateo, J. M. García del Pozo, J. Urdangarín and S. Celma, "Low-Cost TIA and Equalizer For SI-POF". 19th International Conference on Plastic Optical Fibers, Yokohama, Japan, 2010.
- [MAL03] N. R. Malik, "Circuitos Electrónicos – Análisis, Simulación y Diseño". Prentice Hall, 2003.
- [MAT05] J. Mateo, M.A. Losada, J.J. Martínez-Muro, I. Garcés and J. Zubia, "Bandwidth Measurement in POF Based on General Purpose Equipment". XIV International POF Conference, pp. 53-56. Hong Kong, 2005.
- [MAT08] Mathworks, "Matlab Tutorials". <http://www.mathworks.com/academia>. 2008

- [MAX01] Maxim Integrated Circuits, “*MAX3800: 3.2 Gbps Adaptative equalizer and Cable Driver*”. 2001.
- [MAX03] Maxim Integrated Products, “*Designing a Simple, Small, Wide-band and Low-power Equalizer for FR4 Copper Links*”. DesignCon, 2003.
- [MIC08] Micro-Cap 9 by Spectrum Software, “*Electronic Circuit Analysis Program User's Guide*”. <http://www.spectrum-soft.com>, 2008
- [MON99] M. I. Montrose, “*EMC and the Printed Circuit Board – Design, Theory and Layout Made Simple*”. Wiley-Interscience, 1999.
- [NEH06] J. Nehler, “*EM-RJ, das neue Steckverbinderkonzept für POF*”. 21 Meeting of the ITG-SC 5.4.1, Oldenburg, May 2006.
- [OHH99] K. Ohhata, T. Masuda, K. Imai, R. Takeyari and K. Washio, “*A Wide-dynamic Range, High Transimpedance Si Bipolar Preamplifier IC for 10-Gb/s optival fiber links*”. IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 34, No.1, January 1999.
- [R&S09] Rhode & Schwarz, “*R&S ® ZVL Vector Network Analyzer, Operating Manual*”. <http://www2.rohde-schwarz.com>, 2009.
- [RAD05] S. Radovanovic, Anne-Johan Annema, Bram Nauta, “*A 3-Gb/s Optical Detector in Standard CMOS for 850-nm Optical Communication*”. IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 40, no. 8. pp. 1706-1717. August 2005.
- [RAZ03] B. Razavi, “*Design of Integrated Circuits for Optical Communications*”. McGraw-Hill, 2005.
- [RAZ99] B. Razavi, “*CMOS Technology Characterization for Analog and RF Design*”. IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 34, no. 3, pp. 268-276, 1999.
- [SÄC05] E. Säckinger, “*Broadband Circuits for Optical Fiber Communication*”. Wiley-Interscience, 2005.
- [SPE97] R. Spence and R. S. Soin, “*Tolerance Design of Electronics Circuits*”. Imperial College Press, 1997.
- [SUN05] R. Sun, “*A Low-Power 20-Gb/s Continuous-Time Adaptive Passive Equalizer*”. B.S.Tsinghua University 1999, Thesis. December 2005.
- [TAO06] R. Tao, “*The Design of Wide Bandwidth Front-End Amplifiers for High Speed Optical Interconnects*”. Shaker Verlag, 2007.
- [VER03] C. J. M. Verhoeven, A. van Staveren, G. L. E. Monna, M. H. L. Kouwenhoven and E. Yildiz, “*Structures Electronic Design: Negative Feedback Amplifiers*”. Kluwer Academic Publishers, 2003.
- [VER06] J. P. L. Veragüas, “*Compatibilidad Electromagnética – Diseño de Módulos Electrónicos*,” Marcombo, 2006.
- [VIS10] Vishay Semiconductors, “*Silicon PIN Photodiode T1670P*”. <http://www.vishay.com>, 2010.

- [ZIE05] O. Ziemmann and N. Keil, “*Polymer Fiber Applications, Ranging from In-house to the Access network*”. Tutorial Fibercomm Münich, August 2005.
- [ZIE08] O. Ziemann, J. Kranse, P.E. Zamzow and W. Daum, “*POF Handbook Optical Short Range Transmission Systems*”. Springer, 2008.